CATENT COOPERATION TREATY

To:

From the INTERNATIONAL BURE

PCT NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)

Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

18 April 2000 (18.04.00)	in its capacity as elected Office		
International application No. PCT/JP99/04575	Applicant's or agent's file reference HP126N5140		
International filing date (day/month/year) 25 August 1999 (25.08.99)	Priority date (day/month/year) 26 August 1998 (26.08.98)		
Applicant MIYAMA, Yukihiro et al			

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:	
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:	
	22 March 2000 (22.03.00)	
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:	
2.	The election X was	
	was not	
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland **Authorized officer**

Kiwa Mpay

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

				•)	
	- 1				
		*	4.		
					!
		•			
				- , , , -	







1756

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

\					
Applicant's or agent's file reference HP126N5140	FOR FURTHER ACTION	SeeNotificat Examination	tionofTransmittalofInten Report (Form PCT/IF	emational Preliminary PEA/416)	
International application No.	International filing date (day/	month/year)	Priority date (day/mo	onth/year)	
PCT/JP99/04575	25 August 1999 (25	.08.99)	26 August 19	998 (26.08.98)	
International Patent Classification (IPC) or n G02F 1/1337	ational classification and IPC				
Applicant	SAN CHEMICAL INDU	JSTRIES, L	TD.		
This international preliminary examinant and is transmitted to the applicant action.		d by this Interr	national Preliminary Ex	xamining Authority	
2. This REPORT consists of a total of	sheets, include	ing this cover s	sheet.		
been amended and are the ba	This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).				
These annexes consist of a to	tal of sheets.		CT). L700 MAIL R00M	RECEI	
3. This report contains indications relating to the following items:				VED 2001	
Basis of the report			400X		
II Priority	Priority.				
III Non-establishment o	of opinion with regard to novel	ty, inventive st	ep and industrial appli	cability	
IV Lack of unity of inv				·	
V Reasoned statement citations and explan	under Article 35(2) with regard ations supporting such stateme	d to novelty, in nt	iventive step or industr	rial applicability;	
VI Certain documents of	cited				
VII Certain defects in th	e international application				
VIII Certain observations on the international application					
Date of submission of the demand	Date	of completion (of this report		
22 March 2000 (22.0)	3.00)	21 No	ovember 2000 (21.	11.2000)	
Name and mailing address of the IPEA/JP	Autho	orized officer			
Facsimile No.	Telep	hone No.			





International application No.

PCT/JP99/04575

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I.	I. Basis of the report			
1.	With	regard to the elements of the int	ernational application:*	
	\bowtie	the international application as	originally filed	
	Ħ	the description:		
	ىــا	•	, as originally filed	
		2000	, filed with the demand	
			, filed with the letter of	
	Ш	the claims:	i-i-allu Glad	
		pages	, as originally filed	
		pages	, as amended (together with any statement under Article 19	
ļ		pages	, filed with the demand	
		pages	, filed with the letter of	
		the drawings:		
		pages	, as originally filed	
		pages	, filed with the demand	
		pages	, filed with the letter of	
	Ш.	the sequence listing part of the de	escription.	
	ш°		•	
			, as originally filed	
		pages	, filed with the letter of, filed with the demand	
		puges	, filed with the letter of	
2.	the in	nternational application was filed be elements were available or furn the language of a translation fu	elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which I, unless otherwise indicated under this item. hished to this Authority in the following language which is: urnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).	
	\sqcup		the international application (under Rule 48.3(b)).	
		the language of the translation or 55.3).	n furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/	
3.	With	n regard to any nucleotide ar minary examination was carried	nd/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international out on the basis of the sequence listing:	
		contained in the international	application in written form.	
		filed together with the internat	ional application in computer readable form.	
		furnished subsequently to this	Authority in written form.	
		furnished subsequently to this	Authority in computer readable form.	
		The statement that the subsinternational application as file	sequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the ed has been furnished.	
		The statement that the information been furnished.	nation recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has	
4.		The amendments have resulted	d in the cancellation of:	
Ĭ .				
1				
		==	3	
١				
5.		This report has been established beyond the disclosure as filed,	ed as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	
	in th and 7	his report as "originally filed" 70.17).	furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16	
**	' Any r	replacement sheet containing su	ch amendments must be referred to under item I and annexed to this report.	
1				

*



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP99/04575

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

Novelty (N)	Claims	8-13	Y
	Claims	1-7,14,15	NO.
Inventive step (IS)	Claims	8-13	Y
	Claims	1-7,14,15	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-15	YI
	Claims		N

2. Citations and explanations

Claims 1, 2, 6, 7, 14 and 15

Document 1: JP, 4-288365, A (Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.), 13 October, 1992 (13.10.92) describes the subject matters of these claims.

Claims 1, 3-7, 14 and 15

Document 2: JP, 4-116557, A (Sumitomo Bakelite Co., Ltd.), 17 April, 1992 (17.04.92) describes the subject matters of these claims.

Claims 1-15

Document 3: JP, 4-284421, A (Secretary of Agency of Industrial Science and Technology), 9 October, 1992 (09.10.92)

is a document showing the general state of art in this technical field, and describes a technique for orienting liquid crystal by irradiation with light. However, it neither describes nor suggests the orientation treating agent of the present application.

* •



PCT

国際予備審査報告

REC'D 1 | DEC 2000

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 HP126N5140	今後の手続きについては、国際予備審査 I P E A / 4	を報告の送付通知 (様式 P C T / 4 1 6) を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP99/04575	国際出願日 (日.月.年) 25.08.99	優先日 (日.月.年) 26.08.98					
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' G02F1/1337							
出願人 (氏名又は名称) 日産化学工業株式会社							
VII 国際出願の不備							
VⅢ							

国際予備審査の請求書を受理した日 22.03.00	国際予備審査報告を作成した日 21.11.00	
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	2 X 9 2 2 5
日本国特許庁(1PEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	藤岡 善行	1
米水仰で11年度級が第二月日4借3万	電話番号 03-3581-1101 内	線 3295

	y.		•~
	,		*

п		

Ι.		国際予備審査報	&告の基礎		
1.	ŗ		こ提出された差し替え用紙		れた。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。
	X	出願時の国際	除出願書類		
		明細書 明細書 明細書	第 第 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第 第	項、 項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
		図面 図面 図面	第 第 第	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	
		明細書の配列	表の部分 第 表の部分 第 表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
2.	١	上記の出願書類	質の言語は、下記に示す場	合を除くほか、こ(の国際出願の言語である。
	J	上記の書類は、	下記の言語である	語であ	ర .
	[のために提出されたPC		う翻訳文の言語
	l [則48.3(b)にいう国際公開 審査のために提出された		は55.3にいう翻訳文の言語
3.	3	ー この国際出願は	t、ヌクレオチド又はアミ	(ノ酸配列を含んで:	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
	ſ	この国際	出願に含まれる書面によ	る配列表	·
	[出願と共に提出されたフ	•	
	[出された書面による配列表 出されたフレキシブルディスクによる配列表
	l [国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述
	[とフレキシブルディ	スクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述
4.	†		「記の書類が削除された。 第		
	Н	明細書 請求の範囲	第 第	項	•
		図面	図面の第	~ ~	ジ/図
5.		れるので、そ		っのとして作成した。	が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら , (PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上 告に添付する。)

		••
	•	
:		



国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP99/04575

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性について 文献及び説明	ての法第12条	(PCT35条(2)) に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解			
	新規性(N)	・ 請求の範囲 _ 請求の範囲 _		
	進歩性 (IS)	請求の範囲 <u></u> 請求の範囲 _	8~13 1~7, 14, 15	
	産業上の利用可能性(I A)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1~15	有 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求項1,2,6,7,14,15 /文献1:JP、4-288365、A(信越化学工業株式会社)13.10月.1 992(13.10.92)/当該発明について記載されている。

請求項1,3~7,14,15 /文献2:JP、4-116557、A (住友ベークライト株式会社)17.4月. 1992 (17.04.92) /当該発明について記載されている。

請求項1~15 /文献3:JP、4-284421、A(工業技術院長)9.10月.1992(0 9.10.92)/当該技術分野における一般的技術水準を示す文献であって、光を 照射することで液晶を配向する技術について記載されているが、本願配向処理剤に関 しては記載も示唆もされていない。

		36

Original (for SUBMISSION) - printed on

0 0-1	For receiving Office use only International Application No.	
0-2	International Filing Date	
0-3	Name of receiving Office and "PCT International Application"	
0-4	Form - PCT/RO/101 PCT Request	
0-4-1	Prepared using	PCT-EASY Version 2.84 (updated 01.06.1999)
0-5	Petition The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty	
0-6	Receiving Office (specified by the applicant)	Japanese Patent Office (RO/JP)
0-7	Applicant's or agent's file reference	HP126N5140
1	Title of invention	A LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT AGENT AND LIQUID CRYSTAL DEVICE USING THE LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT, AND METHOD FOR ALIGNMENT OF LIQUID CRYSTAL MOLECULES
U U	Applicant	
II-1	This person is:	Applicant only
II-2	Applicant for	All designated States except US
11-4	Name	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
II-5	Address:	7-1, Kandanishiki-cho 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054 Japan
II-6	State of nationality	JB :
11-7	State of residence	JB
II-8	Telephone No.	0474-65-1120
II-9	Facsimile No.	0474-62-5133
III-1	Applicant and/or inventor	
III-1-1	This person is:	Applicant only
III-1-2	Applicant for	All designated States except US
III-1 <i>-</i> 4	Name	SAGAMI CHEMICAL RESEARCH CENTER
III-1-5	Address:	4-1, Nishi-Ohnuma 4-Chome, Sagamihara-shi, Kanagawa 229-0012
		Japan
III-1-6	State of nationality	JP
111-1-7	State of residence	JP

Original (for SUBMISSION) - printed on

III-2	Applicant and/ r inventor	
III-2-1	This person is:	Applicant and inventor
111-2-2	Applicant for	US only
111-2-4	Name (LAST, First)	MIYAMA, Yukihirio
III-2-5 Address:		c/o Nissan Chemical Industries, Ltd.
		Central Research Institute, 722-1,
		Tsuboi-cho, Funabashi-shi, Chiba 274-8507
		Japan
III-2 - 6	State of nationality	JP
III-2 - 7	State of residence	JP
111-3	Applicant and/or inventor	
III-3-1	This person is:	Applicant and inventor
111-3-2	Applicant for	US only
111-3-4	Name (LAST, First)	NIHIRA, Takayasu
III-3-5	III-3-5 Address: c/o Nissan Chemical Industries, Lt	
		Central Research Institute, 722-1,
		Tsuboi-cho, Funabashi-shi, Chiba 274-8507
		Japan
111-3-6	State of nationality	JP .
111-3-7	State of residence	JP
111-4	Applicant and/or inventor	
111-4-1	This person is:	Applicant and inventor
111-4-2	Applicant for	US only
111-4-4	Name (LAST, First)	ENDO, Hideyuki
111-4-5	Address:	c/o Nissan Chemical Industries, Ltd.
		Central Research Institute, 722-1,
		Tsuboi-cho, Funabashi-shi, Chiba 274-8507
		Japan
111-4-6	State of nationality	JP
111-4-7	State of residence	JP
III-5	Applicant and/or inventor	
III-5-1	This person is:	Applicant and inventor
111-5-2	Applicant for	US only
III-5-4	Name (LAST, First)	FUKURO, Hiroyoshi
111-5-5		
	Address:	c/o Nissan Chemical Industries, Ltd.
	Address:	Central Research Institute, 722-1,
	Address:	
	Address:	Central Research Institute, 722-1,
III-5-6	Address: State of nationality	Central Research Institute, 722-1, Tsuboi-cho, Funabashi-shi, Chiba 274-8507
III-5-6 III-5-7		Central Research Institute, 722-1, Tsuboi-cho, Funabashi-shi, Chiba 274-8507 Japan

		• •

PCT F	REQUEST	HP126N5140
!!!-6	Applicant and/or inventor	iginal (for SUBMISSION) - printed on
III-6-1	This person is:	Applicant and inventor
III-6-2	Applicant for	US only
III-6-4	Name (LAST, First)	NAGASE, Yu
III-6-5	Address:	·
111-0-5	Address.	5-2-8-101, Minamidai, Sagamihara-shi,
		Kanagawa 228-0814
W C C	Chata of mationality	Japan
III-6-6	State of nationality	JP
III-6-7 ———	State of residence	JP
111-7	Applicant and/or inventor	
III-7-1	This person is:	Applicant and inventor
III-7-2	Applicant for	US only
III-7-4	Name (LAST, First)	AKIYAMA, Eiichi
111-7-5	Address:	2786-4-211, Shimotsuruma, Yamato-shi,
		Kanagawa 242-0001
		Japan
III-7 - 6	State of nationality	JP
111-7-7	State of residence	JP
111-8	Applicant and/or inventor	
III-8-1	This person is:	Applicant and inventor
111-8-2	Applicant for	US only
111-8-4	Name (LAST, First)	NEMOTO, Nobukatsu
III-8-5	Address:	1801, Kohgasaka, Machida-shi,
		Tokyo 194-0014
		Japan
III-8-6	State of nationality	JP .
111-8-7	State of residence	JP
IV-1	Agent or common representative; or	
	address for correspondence	
	The person identified below is hereby/has been appointed to act on	Agent
	behalf of the applicant(s) before the	•
8444	competent International Authorities as:	
IV-1-1	Name (LAST, First)	HANABUSA, Tsuneo
IV-1-2	Address:	c/o Hanabusa Patent Office, Ochanomizu
	·	Square B
		6, Kandasurugadai 1-chome
		Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062
		Japan
IV-1-3	Telephone No.	03-3291-9721
IV-1-4	Facsimile No.	03-3291-1628
IV-2	Additional agent(s)	additional agent(s) with same address as
		first named agent
IV-2-1	Name(s)	NAKAMURA, Toshio
V	Designation of States	
V-1	Regional Patent	EP: DE FR GB NL and any other State which
	(other kinds of protection or treatment, if any, ar specified between parentheses	is a Contracting State of the European
	after the designation(s) concerned)	Patent Convention and of the PCT

				• . •
				*
			4	
				\
,				

PCT REQUEST HP126N5140

PCIR	REQUEST					HP 120N3 14U
	Ori	ginal (for SL	IBMIS	SION) - printed on	
V-2	National Patent (other kinds of protection or treatment, if any, are specified between parentheses after the designation(s) concerned)	CN	JP	KR	US ·	
V-5	Precautionary Designation Statement In addition to the designations made under items V-1, V-2 and V-3, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all designations which would be permitted under the PCT except any designation(s) of the State(s) indicated under item V-6 below. The applicant declares that those additional designations are subject to confirmation and that any designation which is not confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit.				·	
V-6	Exclusion(s) from precautionary designations	NOI	1E			
VI-1	Priority claim of earlier national application					
VI-1-1	Filing date	26	Aug	j ust	: 1998 (26.08.1998)	
VI-1-2	Number	Pat	ent	: Ar	pplication 10-240491	
VI-1-3	Country	JΡ				
VI-3	Request of a Certified Copy of the earlier application(s) The receiving Office is requested to prepare and transmit to the to the International Bureau a certified copy of item(s) identified on the right column of the earlier application(s) described above.	VI-	·1			
VII-1	International Searching Authority Chosen	Jap	ane	ese	Patent Office (ISA/JP)	
VII-2	Usage Request of Prior Search	_				
VII-2-1	Date					
VII-2-2	Number					
VII-2-3	Country	Jap	an	(JE	?)	

4	•	•	
			9
			·
		÷	
			,

PCT REQUEST

Original (for SUBMISSION) - printed on

Ch ck list		
	Number of sheets	Electronic file(s) attached
Request	6	-
Description	111	-
Claims	9	-
Abstract	1	hp126_abt.txt
Drawings	0	-
TOTAL	127	
Accompanying items	paper document(s) attached	Electronic file(s) attached
Fee calculation sheet	√	-
Fee calculation sheet	✓	-
PCT-EASY diskette	-	Diskette
Other (specified):	Revenue stamps of	-
_	transmittal fee for	
	receiving office	
Other (specified):	Submission of	-
	certificate of	
	payment for	
	international fee	
Other (specified):	Request for	-
l l	Transmittal of	
	Priority document	
Language of filing of the international application	Japanese	4, 24, 1
Signature of applicant or agent		***************************************
Name (LAST, First)	HANABUSA, Tsuneo	
Signature of applicant or agent		:
Name (LAST, First)	NAKAMIDA Tochio	
	Description Claims Abstract Drawings TOTAL Accompanying items Fee calculation sheet Fee calculation sheet PCT-EASY diskette Other (specified): Other (specified): Figure of the drawings which should accompany the abstract Language of filing of the International application Signature of applicant or agent Name (LAST, First)	Description 111 Claims 9 Abstract 1 Drawings 0 TOTAL 127 Accompanying items paper document(s) attached fee calculation sheet

FOR RECEIVING OFFICE USE ONLY

10-1	Date of actual receipt of the purported international application	
10-2	Drawings:	
10-2-1	Received	
10-2-2	Not received	
10-3	Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application	
10-4	Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2)	
10-5	Internati nal Searching Authority	ISA/JP
10-6	Transmittal fs arch copy delayed until search f is paid	



今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)



PCT

国際調査報告

(注8条、法施行規則第40、41条) (PCT18条、PCT規則43、44)

の書類記号 N5140	及び下記5を参照すること。						
国際出願番号 PCT/JP99/04575	国際出願日 (日.月.年) 25.08.99	優先日 (日.月.年) 26.08.98					
出願人 (氏名又は名称) 日産化学工業株式会社	出願人(氏名又は名称) 日産化学工業株式会社						
国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 この写しは国際事務局にも送付される。							
この国際調査報告は、全部で 2	ページである。						
□ この調査報告に引用された先行打	支術文献の写しも添付されている。						
	くほか、この国際出願がされたものに基っ れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査						
b. この国際出願は、ヌクレオチト この国際出願に含まれる書	ド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配 面による配列表	己列表に基づき国際調査を行った。					
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスクによる配列表						
── 出願後に、この国際調査機	関に提出された書面による配列表						
	関に提出されたフレキシブルディスクに						
<u>=</u>		示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述					
□ 書面による配列表に記載し 書の提出があった。	た配列とフレキシブルディスクによる配	列表に記録した配列が同一である旨の陳述					
2.	ができない(第I欄参照)。						
3. [] 発明の単一性が欠如している(第Ⅱ欄参照)。							
4. 発明の名称は 🛛 出願	頭人が提出したものを承認する。						
□ 次6	こ示すように国際調査機関が作成した。						
· · · · · · · · · · · ·							
5. 要約は 🗓 出願	頭人が提出したものを承認する。						
		第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ きる。					
6. 要約書とともに公表される図は、 第 図とする。 □ 出版	頼人が示したとおりである。	図 なし					
	類人は図を示さなかった。						
・ 🗌 本国	図は発明の特徴を一層よく表している。						

	•	er.		•
,	÷			
		•		
	4	49		÷
4.				
		12	4	

	国際調査報告	国際出願番号	PCT/JP9	9/04575
A. 発明の原	異する分野の分類(国際特許分類(IPC))			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Int.	C16 G02F1/1337	·		-
B. 調査を行				
調査を行った量	&小限資料(国際特許分類(IPC))			
Int.	C16 G02F1/1337			
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの			
	用新案公報 1922-1996年 開実用新案公報 1971-1999年			
国際調査で使用		こ使用した用語)		
		•		
C. 関連する	5と認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	、 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、	その関連する質	節の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP、4-288365, A (信越化学工月. 1992 (13. 10. 92) (ファ		13.10	1, 2, 6, 7, 14, 15
X	JP、4-116557, A(住友ベーク 4月.1992(17.04.92)(フ	ライト株式会 アミリーなし	会社) 17. し)	1、3~7, 1 4, 15
A	JP、4-284421, A (工業技術院 2 (09.10.92) (ファミリーなし	送 長)9.1 ()))月. 199	1~15
A	JP、4-288365, A (信越化学工月、1992 (13.10.92) (ファ	「業株式会社) ・ミリーなし)	13.10	12、13
│ C欄の続き	▼ さにも文献が列挙されている。	 パテントファ	ミリーに関する別	 紙を参照。
		<u> </u>		
もの 「E」国際出願	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」 頭日前の出願または特許であるが、国際出願日	て出願と矛盾す 論の理解のため	t優先日後に公表だるものではなく、 かに引用するもの	された文献であって 発明の原理又は理 当該文献のみで発明
「L」優先権3 日若しく 文献(5	E張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」 里由を付す)	の新規性又は近 特に関連のある 上の文献との、	生歩性がないと考え 5文献であって、 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
	よる開示、使用、展示等に言及する文献 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」	よって進歩性か 同一パテントフ	がないと考えられ。 ファミリー文献	るもの

国際調査報告の発送日

特許庁審査官(権限のある職員)

藤岡 善行

30.11.99

電話番号 03-3581-1101 内線 3295

2 X | 9 2 2 5

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

19.11.99

国際調査を完了した日

国際調査機関の名称及びあて先

		•	
			2
(4) VI (4)))		
			*
·,			٠
		ú.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/04575

A. CLASS	GIFICATION OF SUBJECT MATTER C16 G02F1/1337	*	
	~4/		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC	1
	SSEARCHED		
Minimum de Int.	ocumentation searched (classification system followed C1 ⁶ G02F1/1337	by classification symbols)	
Jits Koka	ion searched other than minimum documentation to the uyo Shinan Koho 1922-1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999		
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.
х	JP, 4-288365, A (Shin-Etsu Chem 13 October, 1992 (13.10.92) (nical Co., Ltd.), Family: none)	1,2,6,7,14,15
х	JP, 4-116557, A (Sumitomo Bakel: 17 April, 1992 (17.04.92) (Fa	ite Company, Limited.), mily: none)	1,3~7,14,15
A	JP, 4-284421, A (Agency of Indu Technology), 09 October, 1992 (09.10.92) (1~15	
A	_		
	-		·
	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completi n of the internati nal search 19 November, 1999 (19.11.99) "T" later document published after the international filing of the international search "T" later document published after the international filing middle after the international filing date and not in conflict with to understand the priority date and not in conflict with to understand the prior			ne application but cited to enlying the invention calaimed invention cannot be red to involve an inventive claimed invention cannot be to when the document is documents, such a skilled in the art family
Name and m	ailing address f the ISA/	Authorized officer	
	nese Patent Office		
Facsimile No	o.	Telephone No.	

		4 T 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
			~.
			10
		y, -10-	
•			÷ ·
ż		$\hat{m{k}}$, r_{*} , r_{*}	
(4)	*		
		*	
¥			
		· · ·	
	W. v.		
5.			
	Y Y		
	Y X		
	9 1		
takit tito (tito). ≠		2 g	,
me to the second			
8.7		A Land	± (1)
5 ° • • • • • • • • • • • • • • • • • •		e	
	54 -	And the second second second second	ë :
		Area and Are	3
			ş.V

			311/64
		Y	. 1919

PCT

世界知的所有権機関 際 事 務 局



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6 G02F 1/1337

A1

(11) 国際公開番号

WO00/13058

(43) 国際公開日

2000年3月9日(09.03.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/04575

(22) 国際出願日

1999年8月25日(25.08.99)

(30) 優先権データ

特願平10/240491

1998年8月26日(26.08.98)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

日産化学工業株式会社

(NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.)[JP/JP]

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1 Tokyo, (JP)

財団法人 相模中央化学研究所

(SAGAMI CHEMICAL RESEARCH CENTER)[JP/JP]

〒229-0012 神奈川県相模原市西大沼4丁目4番1号

Kanagawa, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

見山幸広(MIYAMA, Yukihiro)[JP/JP]

仁平貴康(NIHIRA, Takayasu)[JP/JP]

遠藤秀幸(ENDO, Hideyuki)[JP/JP]

袋 裕善(FUKURO, Hiroyoshi)[JP/JP]

〒274-8507 千葉県船橋市坪井町722番地1

日産化学工業株式会社 中央研究所内 Chiba, (JP)

長瀬 裕(NAGASE, Yu)[JP/JP]

〒228-0814 神奈川県相模原市南台5-2-8-101 Kanagawa, (JP)

秋山映一(AKIYAMA, Eiichi)[JP/JP]

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間2786-4-211 Kanagawa, (JP)

根本修克(NEMOTO, Nobukatsu)[JP/JP]

〒194-0014 東京都町田市高ヶ坂1801 Tokyo, (JP)

(74) 代理人

萼 経夫, 外(HANABUSA, Tsuneo et al.)

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1丁目6番地

お茶の水スクエアB館 専特許事務所内 Tokyo, (JP)

CN, JP, KR, US, 欧州特許 (DE, FR, GB, NL) (81) 指定国

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: TREATING AGENT FOR LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT LAYER AND LIQUID CRYSTAL DEVICE USING THE SAME, AND METHOD FOR ALIGNMENT OF LIQUID CRYSTAL

液晶配向処理剤及びそれを用いた液晶素子並びに液晶の配向方法 (54)発明の名称

$$-c_{0}^{R^{1}} - (1) \quad -c_{0}^{R^{1}} - (2) \quad -c_{0}^{R^{1}} - (3)$$

$$-c_{-N}^{R'}-c_{-N}^{C}-(4) \qquad -c_{-N}^{R'}-N^{R'}-c_{-N}^{R'}-(5)$$

A treating agent for a liquid crystal alignment layer for use in the optical alignment, which comprises a polymeric compound having, in the main chain thereof, at least one of the bonds represented by general formulae (1) to (7); wherein R¹, R² and R³ independently represent a hydrogen atom, an alkyl group, a substituted alkyl group, an allyl group or a propargyl group, both ends of the bond being directly bonded to two- or three-valent aromatic groups or one end of the bond being directly bonded to a two- or three-valent aromatic group and the other end being directly bonded to a two- or three-valent alicyclic hydrocarbon group, and having a number average molecular weight of 1,000 to 300,000; a liquid crystal device manufactured by using the same; and a method for the alignment of a liquid crystal using the treating agent for a liquid crystal alignment layer. The treating agent is used for carrying out the alignment of a liquid crystal by using the irradiation of a light to an alignment layer without subjecting the layer to rubbing treatment. The use of the treating agent results in performing a uniform alignment of a liquid crystal with efficiency, the alignment being highly stable and resistant to light.



(目的)液晶配向膜への光照射により液晶配向膜のラビングを必要とせずに液晶を配向させる方法に於いて、均一な液晶配向を効率的に発現し、更に発現した配向が高い安定性及び耐光性を有するものである液晶配向処理剤及びそれを用いた液晶素子、並びに該液晶配向処理剤を用いる液晶の配向方法を提供する。

(発明の構成) 高分子主鎖中に下記一般式(1)~(7)

(R¹、R²、及びR³はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、置換アルキル基、 アリル基またはプロパルギル基を表す。)

で表されるいずれかの結合を有し、上記結合の両端に2価または3価の芳香族基が直接結合するか、または上記結合の片端に2価または3価の芳香族基が直接結合しかつもう一方の片端に2価または3価の脂環式炭化水素基が直接結合する数平均分子量が1000~30000の高分子化合物からなる、液晶配向処理剤及びそれを用いた液晶素子、並びに該液晶配向処理剤を用いる液晶の配向方法に関する。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

明細書

液晶配向処理剤及びそれを用いた液晶素子並びに液晶の配向方法

技術分野

本発明は液晶の配向処理剤及びそれを用いた液晶素子に関するものであり、更に詳しくはラビング処理を必要とすることなく、高分子薄膜表面に光を照射することにより液晶分子を配向させる方法に於いて用いられる新規な液晶配向処理剤、液晶素子及び液晶の配向方法に関するものであり、特定の単位構造を有する高分子を含有する液晶配向処理剤を用いることにより、上記方法の従来の技術に対して、高感度化を実現し、且つ液晶配向の高い熱的安定性、高い耐光性を達成することを特徴とする。

背景技術

液晶表示素子は、液晶の電気光学的変化を利用した表示素子であり、装置的に小型軽量であり、消費電力が小さい等の特性が注目され、近年、各種ディスプレイ用の表示装置として目覚ましい発展を遂げている。中でも正の誘電率異方性を有するネマティック液晶を用い、相対向する一対の電極基板のそれぞれの界面で液晶分子を基板に対し平行に配列させ、且つ、液晶分子の配向方向が互いに直交するように両基板を張り合わせた、ツイステッドネマティック型(TN型)の電界効果型液晶表示素子はその代表的なものである。

このようなTN型の液晶表示素子に於いては、液晶分子の長軸方向を基板表面に均一且つ平行に配向させること、更に液晶分子を基板に対して一定の傾斜配向角(以下、プレチルト角という)をもって配向させることが重要である。このように液晶分子を配向させる方法としては、従来より2つの方法が知られている。

第一の方法は、酸化珪素等の無機物を基板に対して斜めから蒸着することにより基板上に無機膜を形成し、蒸着方向に液晶分子を配向させる方法である。この方法では、一定のプレチルト角を有する安定した配向は得られるものの工業的に効率的ではない。

WO 00/13058 PCT/JP99/04575

第二の方法は、基板表面に有機被膜を設け、その表面を綿、ナイロン、ポリエステル等の布で一定方向にラビングし、ラビング方向に液晶分子を配向させる方法である。有機被膜は、通常、液晶配向処理剤を基板表面に塗布することにより形成される。この方法は、比較的容易に安定した配向が得られるため、工業的には専らこの方法が採用されている。有機被膜(液晶配向膜または配向膜という。)としては、ポリビニルアルコール、ポリオキシエチレン、ポリアミド、ポリイミド等の高分子化合物からなる膜が挙げられるが、機械的強度、化学的安定性、熱的安定性等の点からポリイミド膜が最も一般的に使用されている。このような液晶配向膜に使用されているポリイミドの代表的な例としては、特開昭61-47932号公報に開示されるものがある。

ポリイミド膜をラビングする液晶配向処理方法は、簡便で生産性に優れた工業 的に有用な方法である。しかし、液晶表示素子の高性能化、高精細化への要求は 益々高まり、それに対応した新しい表示方式が開発されるに伴って、ラビング法 の様々な問題が指摘されるようになった。例えば、TN型液晶表示のツイスト角 を高くしたSTN(スーパーツイステッドネマティック)方式、強誘電性液晶、 反強誘電性液晶を用いたFLC(フェロエレクトリック)、AFLC(アンチフ エロエレクトリック)方式、個々の電極にスイッチング素子を形成したAM(ア クティブマトリクス) 方式等がそれである。STN方式ではコントラストが高い ためラビングによって生じた配向膜表面の傷が表示欠陥となってしまい、FLC、 AFLC方式では単純なラビング処理だけではスメクチック液晶の均一配向と高 速応答を両立させることが難しく、AM方式ではラビングによる機械的な力や静 電気がスイッチング素子を破壊したり、ラビングによる発塵が表示欠陥を誘発し たり、または液晶の汚染を引き起こし表示品位の低下を招くこともある等、ラビ ング法の様々な問題が明らかになってきている。特にAM方式は液晶をTFT (薄膜トランジスタ) 等の半導体素子で駆動する方式であり、元来極めてクリー ンさ(清浄性)が要求される半導体技術に於いて、ラビングのようなプロセスは 厳密には最適とは言えない。

これらの問題を解決する目的で、ラビングなしで液晶を配向させるいわゆる「ラビングレス」配向法が検討され、様々な方法が提案されている。例えば、配

向膜表面にフォトクロミック分子を導入し、光によって配向膜表面の分子を配向させる方法(特開平4-2844号公報)、LB膜(ラングミュアブロジェット膜)を用いて配向膜を構成する分子膜配向させる方法(小林等、ジャパニーズジャーナル オブ アプライド フィジックス、27巻、475ページ(1998)、8年))(S. Kobayashi et.al., Jpn. J. Appl. Phys., 27, 475(1998))、あらかじめ配向処理された基板上に配向膜を圧着して配向を移し取る方法(特開平6-43458号公報)等が検討されているが、工業的な生産性を考慮した場合に、ラビング法の代替となりうるものとは言えない。

これに対して、配向膜表面の周期的な凹凸を人為的に形成し、この凹凸に沿って液晶分子を配向させる様々な方法も提案されている。その最も単純な方法は、予め周期的な凹凸を有するレプリカを作製し、その上に熱可逆的な膜を加熱圧着し、膜上に凹凸を移し取る方法である。(特開平4-172320号公報、特開平4-296820号公報、特開平4-311926号公報等。)この方法では確かに表面に周期的な凹凸を有する膜を効率的に作製することは可能であるが、ラビング法で用いられているポリイミド膜ほどの実用上の信頼性を得ることは出来なかった。これに対して、信頼性の高いポリイミド膜に高エネルギーの光、例えば電子線(特開平4-97130号公報)、α線(特開平2-19836号公報)、X線(特開平2-2515号公報)、エキシマレーザー(特開平5-53513号公報)等を照射し、膜表面に周期的な凹凸を形成する方法が提案されている。しかし、これらの高エネルギーの光源を用いることは、大型の基板全面に均一に配向処理を連続的に行うという工業的な生産性を考慮した場合、効率的な配向処理方法とは言い難いものであった。

一方、信頼性の高いポリイミド膜表面に周期的な凹凸を形成する効率的な方法として、フォトリソグラフィー法がある。即ち、近年開発された光硬化性ポリイミドを用いてフォトリソグラフィー法により周期的な凹凸を形成しようとする試みである。この方法によって、確かにポリイミド膜表面に凹凸を形成することはできるものの、元来光硬化性のポリイミドは絶縁膜として開発されたものであるため、液晶を配向させるための特性は不十分なものとなり、更にバッファー層をコーティングする等の必要性を生じ(特開平4-245224号公報)、結果的

WO 00/13058 PCT/JP99/04575

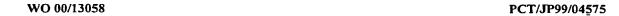
にプロセスが複雑となり、工業的な生産性を考慮するとラビング法の代替となり 得るだけの効率的な配向処理方法とはなり得なかった。

最近見いだされた新たな配向処理方法として、偏光した紫外線等を高分子膜表面に照射し、ラビング処理することなく液晶分子を配向させる方法が提案されている。その例として以下の報告がある。

ギボンズ等、ネーチャー、351巻、49ページ(1991年)(W. M. Gibbons et. al., Nature, 351, 49(1991))、川西等、モレキュラー クリスタル アンド リキッド クリスタル、218巻、153ページ(1992年)(Y. Kawanis hi et. al., Mol. Cryst. Liq. Cryst., 218, 153(1992))、シャト等、ジャパニーズ ジャーナル オブ アプライド フィジックス、31巻、2155(1992))、飯村等、ジャパニーズ ジャーナル オブ アプライド フィジックス、31, 2155(1992))、飯村等、ジャパニーズ ジャーナル オブ アプライド フィジックス、32巻、L93ページ(1993年)(Y. Iimura et. al., Jpn. J. Appl. Phys., 32, L93(1993))。

これらの方法は、従来のラビング処理を必要とせず、偏光した光照射により一定方向に液晶を配向させることが特徴である。この方法によれば、ラビング法による膜表面の傷や静電気等の問題がなく、また工業的な生産性を考慮した際の製造プロセスとしてより簡便であることが利点である。即ち、ここに提案されている偏光した光照射を利用する液晶配向処理方法は、未だ基礎的な研究段階ではあるが、今後ラビング処理を用いない新たな液晶配向処理方法として注目される方法と目される。

これまでの報告においては、液晶配向膜材料として、偏光した光に対する光化学的感度を得る必要性から、高分子の側鎖に光反応性基を導入した高分子化合物を用いることが提案されている。その代表的な例としてポリビニルシンナメートが挙げられており、この場合光照射による側鎖部分での二量化により高分子膜中に異方性を発現し液晶を配向させるものと考えられている。また、その他として高分子材料中に低分子の二色性アゾ系色素を分散し、この膜表面に対して偏光した光を照射することで一定の方向に液晶分子を配向させうることが述べられている。また更には、特定のポリイミド膜に偏光した紫外線等を照射することによっ



て液晶分子が配向することが報告されている。この場合光照射により、一定方向 のポリイミド主鎖が分解することにより液晶の配向を発現しているものと考えら れる。

ポリビニルシンナメート等に代表される高分子側鎖に光反応性基を導入した高分子材料系では、配向の熱的安定性が十分ではなく実用の面では未だ十分な信頼性が得られていない。また低分子の二色性色素を高分子中に分散した場合には、液晶を配向させる色素自体が低分子であり、実用的な観点から考えて、その分散系は熱的または光に対する安定性の面に課題が残されている。更に、特定のポリイミドに偏光した紫外線を照射する方法に於いては、ポリイミド自体としては耐熱性等の信頼性は高いものの、その配向機構が光による分解に起因していると考えられることから、今後実用面に於いて必ずしも十分な信頼性が得られない可能性がある。更に、十分な液晶配向を得るための光照射エネルギーが高くなってしまい、生産性が低下するといった問題を有している。

これらの点で、従来の光照射による液晶配向に対して提案されている材料は配向力及びその安定性、更に感度という面で必ずしも十分ではなく、光照射によるラビングレス配向を実用化する上で大きな課題となっているのが実状である。

発明の開示

本発明の目的は、液晶配向膜への光照射により液晶配向膜のラビングを必要と せずに液晶を配向させる液晶配向処理剤であって、特定の単位構造を有する高分 子材料系で、均一且つ安定な液晶配向を効率的に発現し、更に発現した配向が高 い熱的安定性及び耐光性を有するものである液晶配向処理剤を提供することにあ る。

本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意努力検討した結果本発明を完成させるに至った。即ち、本発明は、液晶配向処理剤を用いて基板上に形成された高分子薄膜に光または電子線を基板面に対して照射し、次いで該基板上にラビング処理なしに液晶を配向させる方法において用いられるところの液晶配向処理剤であって、高分子主鎖中に下記一般式(1)~(7)

(R'、R'及びR'はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリル基またはプロパルギル基を表す。)

で表されるいずれかの結合を有し、上記結合の両端に2価または3価の芳香族基が直接結合するか、または上記結合の片端に2価または3価の芳香族基が直接結合しかつもう一方の片端に2価または3価の脂環式炭化水素基が直接結合する数平均分子量が1000~30000の高分子化合物からなる、液晶配向処理剤及びそれを用いた液晶素子、並びに該液晶配向処理剤を用いる液晶の配向方法に関する。

上述したように、偏光照射を用いた液晶配向を実際に応用する場合には、液晶を単に初期的配向させるだけでなく、信頼性且つ生産性の観点から、より効率的に且つ安定な配向を発現させることが必要とされる。また、実際の工業的な応用を考えた場合、熱的にまたは光にも高い安定性をもった高分子構造を選択することが望まれ、且つより幅広い構造選択幅をもつ高分子材料系を使用した液晶処理剤を見いだすことが望まれる。

本発明に於ける液晶配向処理剤とは、液晶の配向、プレチルト角等の制御を行うために、ガラスまたはプラスチック等の電極基板に塗布して該基板上に高分子 薄膜を形成するものを意味する。即ち、本発明の液晶配向処理剤は、透明電極の ついたガラスまたはプラスチックフィルム等の電極基板上に、本発明の液晶配向

処理剤を塗布、焼成することにより高分子薄膜を形成し、次いで膜面に光または電子線を照射することによりラビング処理を必要としない液晶配向膜を作製するために使用するものである。本発明の液晶配向処理剤は、通常、溶液の形で使用される。

本発明の液晶配向処理剤で形成される高分子薄膜としては、該高分子薄膜を形成する高分子化合物が主鎖中に上記一般式(1)~(7)で表されるいずれかの結合を有し、且つ上記結合の両端に2価または3価の芳香族基が直接結合し、もう一方の片端に2価または3価の芳香族基が直接結合し、もう一方の片端に2価または3価の脂環式炭化水素基が直接結合した構造が導入されていることが、光または電子線照射時の効率的且つ均一安定な液晶配向の発現等、本発明の効果を奏する上で重要である。また、この構造を含有する高分子の単位構造が20から100モル%含まれることが、効率的に液晶を配向させる観点から好ましい。上記の芳香族基及び脂環式炭化水素基は置換基を有していてもよい。更に、高分子の持つガラス転移点が200℃以上であることが配向の熱的安定性を得る上で好ましい。基板上に形成された高分子薄膜が光照射によって化学的に変化し、その反応生成物が200℃以上のガラス転移点を有するものであってもよい。なお、光または電子線の照射により二量化反応または異性化反応が誘起される下記一般式(8)~(17)

(R⁺、R⁵、R⁶、R⁷、R⁸及びR⁹はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、

アルキル基、置換アルキル基、置換アルコキシ基、カルボキシル基、アルコキシ カルボニル基またはシアノ基を表す。)

で表される置換基を含有する必要はない。

前記一般式(1)~(7)中R¹~R³で表される置換基のうちアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、iープロピル、ブチル、iーブチル、sープロピル及びtーブチル等の低級アルキル基に加え、通常用いられる炭素数24程度までの長鎖アルキル基が好適な例として挙げられる。また、置換アルキル基としては、トリフルオロメチル、2,2,2ートリフルオロエチル、ペルフルオロエチル、3,3,3ートリフルオロプロピル、ペルフルオロプロピル、ヘキサフルオローiープロピル、3,3,4,4,4ーベンタフルオロブチル及びペルフルオロブチル等の低級含フッ素アルキル基、通常用いられる炭素数24程度までの長鎖含フッ素アルキル基、ベンジル基、及びベンゼン環上にハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基等が置換したベンジル基等が好適な例として挙げられる。

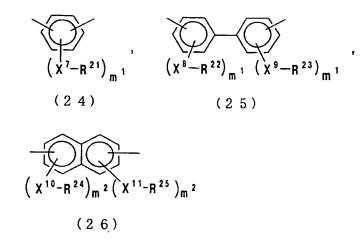
本発明に於ける高分子化合物としては、上記一般式(1)~(7)で表されるいずれかの結合を有し、上記結合の両端に2価または3価の芳香族基が直接結合するか、または上記結合の片端に2価または3価の芳香族基が直接結合しかつもう一方の片端に2価または3価の脂環式炭化水素基が直接結合する構造を含有していれば特に限定されないが、上記の観点から、ポリアミド、ポリウレタン、ポリウレア、または上記一般式(1)~(7)で表されるいずれかの結合を含有するポリイミド前駆体またはそのポリイミド前駆体を化学的または熱的にイミド化して得られるポリイミド等が好ましい。

例えば、高分子化合物として下記一般式(18)または、一般式(19a)および(19b)

(R¹⁰、R¹¹、R¹²及びR¹³は一般式(20)~(23)

$$(x^{1}-R^{14})_{m}, (x^{2}-R^{15})_{m}, (x^{3}-R^{16})_{m}, (x^{4}-R^{17})_{m}, (x^{2}-R^{18})_{m}, (x^{2}-R^{19})_{m}, (x^{2}-R^{19})_{m}, (x^{3}-R^{18})_{m}, (x^{4}-R^{17})_{m}, (x^{$$

 $(X^1, X^2, X^3, X^4, X^6$ 及び X^6 はそれぞれ独立に単結合、O、 CO_2 、 OCO_3 、 CO_4 0、 CO_4 0 CO_4 0 CO



 $(X^7, X^8, X^9, X^{10}$ 及び X^{11} はそれぞれ独立に単結合、O、 CO_2 、OCO、 CH_2O 、NHCOまたはCONHを表し、 R^{21} 、 R^{22} 、 R^{23} 、 R^{24} 及び R^{25} はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、 $C_1\sim C_{24}$ のアルキル基、 $C_1\sim C_{24}$ の含フッ素アルキル基、アリル基、プロパルギル基、フェニル基または置換フェニル基を表し、 m^1 は $1\sim 4$ の整数を表し、 m^2 は $1\sim 3$ の整数を表す。ただし、 R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} 、 R^{17} 、 R^{18} 、 R^{19} 、 R^{21} 、 R^{22} 、 R^{23} 、 R^{24} 及び R^{25} が水素原子またはハロゲン原子を表す場合には、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 X^4 、 X^5 、 X^6 、 X^7 、 X^8 、 X^9 、 X^{10} 及び X^{11} は単結合を表す。)

で表される基を示す。)

で表される2価の有機基を示し、R^{a1}、R^{a2}、R^{a3}及びR^{a4}はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリル基またはプロパルギル基を表す。)

で表される繰り返し単位よりなるポリアミドを挙げることができる。

更に、実用性及び汎用性を考慮すれば、上記一般式(18)に於ける R^{10} 及び R^{11} 、または一般式(19a)及び(19b)に於ける R^{12} 及び R^{13} がそれぞれ 独立に下記式(27)~(41)

で表される基から選ばれるものであることが好ましい。

上記一般式(20)~(26)中、 R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} 、 R^{17} 、 R^{18} 、 R^{19} 、 R^{21} 、 R^{22} 、 R^{23} 、 R^{24} 、 R^{25} で表される C_1 ~ C_{24} のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、i-プロピル、ブチル、i-ブチル、s-ブチル及び t- ブチル等の低級アルキル基に加え、通常用いられる長鎖アルキル基、及び シクロヘキシル基、ビシクロヘキシル基等の脂環式炭化水素基を含むアルキル基が挙げられる。 C_1 ~ C_{24} の含フッ素アルキル基としては、トリフルオロメチル、

2, 2, 2-トリフルオロエチル、ペルフルオロエチル、3, 3, 3-トリフルオロプロピル、ペルフルオロプロピル、ヘキサフルオロ-i-プロピル、3, 3, 3-トリフル4, 4, 4-ペンタフルオロブチル及びペルフルオロブチル等の低級含フッ素アルキル基に加え、通常用いられる長鎖含フッ素アルキル基が挙げられる。

また、置換フェニル基における置換基としては、ハロゲン原子、アルキル基、 含フッ素アルキル基、アルコキシ基、含フッ素アルコキシ基、アルコキシカルボ ニル基、含フッ素アルコキシカルボニル基等が挙げられる。

上記一般式中、R*1、R*2、R*3及びR*4で表される基は前記一般式(1)中のR'で表される基と同様である。R*1、R*2、R*3及びR*4で表される基が水素原子以外の基を含む上記ポリアミドは、以下に示す方法で得られる。

R^{a1}、R^{a2}、R^{a3}及びR^{a4}で表される基が水素原子であるポリアミドのアミド基のN位に既知の高分子反応(モーレイ等、ジャーナル オブ アプライド ポリマー サイエンス、45巻、1983ページ(1992年)(T.H.Mourey et.al., J. Appl. Polym. Sci., 45, 1983 (1992))、高柳等、ジャーナル オブ ポリマー サイエンス、ポリマー ケミストリー エディション、19巻、1133ページ(1981年)(M. Takayanagi et.al., J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed., 19, 1133 (1981))等参照)を利用して所望の置換基を所望の割合で導入することにより得られる。

また、以下に例示するジアミンモノマー化合物のN位にあらかじめ所望の置換基を導入し、得られた化合物をモノマーとして用いて重合反応を行うことにより製造することも可能である。

上記一般式(18)中のR¹⁰に対応するジカルボン酸成分を構築するためのモノマー化合物の具体例としては、テレフタル酸、イソフタル酸、2ーメチルーイソフタル酸、4ーメチルーイソフタル酸、5ーメチルーイソフタル酸、5ーアリルオキシイソフタル酸、5ーアリルオキシカルボニルイソフタル酸、5ープロパルギルオキシイソフタル酸、5ーアセチルオキシイソフタル酸、5ーベンゾイルアミノイソフタル酸、テトラフルオロイソフタル酸、メチルテレフタル酸、テトラフルオロテレフタル酸、2,6ーナフタレンジカルボン酸、1,6ーナフタレンジカルボン酸、2,6ーアントラセンジカルボン酸、1,6ーアントラセンジ

カルボン酸、4、4′ージカルボキシビフェニル、3、4′ージカルボキシビフ ェニル、2,3′ージカルボキシピフェニル、2,4′ージカルボキシビフェニ ル、4,4′-ジカルボキシジフェニルエーテル、3,4′-ジカルボキシジフ ェニルエーテル、2,3′ージカルボキシジフェニルエーテル、2,4′ージカ ルボキシジフェニルエーテル、3,3′-ジカルボキシジフェニルエーテル、3, 3′-ジメチル-4,4′-ジカルボキシビフェニル、4,4′-ジメチル-3, 3´ージカルボキシビフェニル、2,2´ージメチルー4,4´ージカルボキシ ビフェニル、3, 3´ージメトキシー4, 4´ージカルボキシビフェニル、4, 4′-ジメトキシ-3,3′-ジカルボキシビフェニル、2,2′-ジメトキシ -4,4¹-ジカルボキシビフェニル、4,4¹-ジカルボキシベンゾフェノン、 3,4′-ジカルボキシベンゾフェノン、3,3′-ジカルボキシベンゾフェノ ン、4,4^-ジカルボキシジフェニルメタン、3,4^-ジカルボキシジフェ ニルメタン、3,3´ージカルボキシジフェニルメタン、3,3´ージメチルー 4, 4 ′ ージカルボキシジフェニルメタン、2, 2 ′ ージメチルー4, 4 ′ ージ カルボキシジフェニルメタン、4,4′-ジメチル-3,3′-ジカルボキシジ フェニルメタン、3,3'ージメトキシー4,4'ージカルボキシジフェニルメ タン、2,21-ジメトキシー4,41-ジカルボキシジフェニルメタン、4, 4′-ジメトキシ-3,3′-ジカルボキシジフェニルメタン、4,4′-ジカ ルボキシベンズアニリド、3,4′ージカルボキシベンズアニリド、4,4′ー ジカルボキシジフェニルスルホン、3,4´ージカルボキシジフェニルスルホン、 3, 3'-ジカルボキシジフェニルスルホン、2, 2-ビス(4-カルボキシフ ェニル)プロパン、1,4-ビス(4-カルボキシフェノキシ)ベンゼン、1. 3-ビス(4-カルボキシフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(4-カルボキ シベンズアミド)ベンゼン、1,4-ビス(4-カルボキシベンズアミド)ベン ゼン、ビス(4-カルボキシフェノキシフェニル)メタン、4、4′-ビス(4 ーカルボキシフェノキシ)ジフェニルスルホン、2,2ービス[4-(4-カル ボキシフェノキシ)フェニル]プロパン、2、2-ビス(4-カルボキシフェニ ル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス[4-(4-カルボキシフェノキ シ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、1.5-ビス(4-カルボキシフェニ

ル)ペンタン、1,4ービス(4ーカルボキシフェニル)ブタン、1,3ービス(4ーカルボキシフェニル)プロパン、ジ(4ーカルボキシフェニル)ペンタンー1,5ージオエート、ジ(4ーカルボキシフェニル)へキサンー1,6ージオエート、ジ(4ーカルボキシフェニル)へプタンー1,7ージオエート等の芳香族または芳香族含有ジカルボン酸及びこれらの酸ハロゲン化物並びにアルキルエステル化物、更には1,3ージカルボキシシクロヘキサン、1,4ージカルボキシシクロヘキサン、1,2ージカルボキシシクロブタン、1,3ージカルボキシシクロブタン、ビス(4ーカルボキシシクロブタン、ビス(4ーカルボキシシクロベキシル)メタン、ビス(4ーカルボキシー3ーメチルシクロヘキシル)エーテル、ビス(4ーカルボキシー3ーメチルシクロヘキシル)エーテル、ビス(4ーカルボキシー3ーメチルシクロへキシル)エーテル等の脂環式ジカルボン酸及びこれらの酸ハロゲン化物並びにアルキルエステル化物が挙げられ、またこれらの2種類以上の混合物を使用することもできる。

上記一般式(18)中のR¹¹に対応するジアミン成分を構築するためのモノマー化合物の具体例としては、p-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、2-メチル-m-フェニレンジアミン、4-メチル-m-フェニレンジアミン、5-メチル-m-フェニレンジアミン、2,4,6-トリメチル-m-フェニレンジアミン、5-アリルオキシメチル-m-フェニレンジアミン、5-アリルオキシメチル-m-フェニレンジアミン、メチル-p-フェニレンジアミン、2,5-ジメチル-p-フェニレンジアミン、2,6-ナフタレンジアミン、1,6-ナフタレンジアミン、2,6-アントラセンジアミン、2,7-ジアミノフルオレン、4,4'-ジアミノビフェニル、3,4'-

ジアミノビフェニル、2,3′-ジアミノビフェニル、2,4′-ジアミノビフ エニル、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、3,4'-ジアミノジフェニ ルエーテル、2,3′ージアミノジフェニルエーテル、2,4′ージアミノジフ ェニルエーテル、3,3′ージアミノジフェニルエーテル、4,4′ージアミノ ジフェニルスルフィド、3,3^-ジメチル-4,4^-ジアミノビフェニル、 4, 4[^] -ジメチル-3, 3[^] -ジアミノビフェニル、2, 2[^] -ジメチル-4, 4'-i(y)=1ニル、4,4´ージメトキシー3,3´ージアミノビフェニル、2,2´ージメ トキシー4、4´ージアミノビフェニル、4、4´ージアミノベンゾフェノン、 3, 4′-ジアミノベンゾフェノン、3, 3′-ジアミノベンゾフェノン、4, 4´ージアミノジフェニルメタン、3,4´ージアミノジフェニルメタン、3, 3´ージアミノジフェニルメタン、3,3´ージメチルー4,4´ージアミノジ フェニルメタン、4,4′-ジメチル-3,3′-ジアミノジフェニルメタン、 2, 2 ^ ージメチルー 4, 4 ^ ージアミノジフェニルメタン、 3, 3 ^ , 5, 5 ^ -テトラメチル-4,4^ -ジアミノジフェニルメタン、3,3^ -ジメトキ シー4,4^-ジアミノジフェニルメタン、4,4^-ジメトキシー3,3^-ジアミノジフェニルメタン、2,2'-ジメトキシ-4,4'-ジアミノジフェ ニルメタン、4,4´ージアミノジフェニルエタン、4,4´ージアミノジフェ ニルアミン、3, 4′ージアミノジフェニルアミン、4, 4′ージアミノベンズ アニリド、3,4′ージアミノベンズアニリド、4,4′ージアミノジフェニル スルホン、3,4′ージアミノジフェニルスルホン、3,3′ージアミノジフェ ニルスルホン、2, 2′ージアミノジフェニルプロパン、1, 4ービス(4ーア ミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、 1, 3-ピス(4-アミノベンズアミド)ベンゼン、1, 4-ビス(4-アミノ ベンズアミド)ベンゼン、4,4′-(4-アミノフェノキシフェニル)メタン、 4, 4´ービス(4ーアミノフェノキシ)ジフェニルスルホン、2,2ービス [4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2,2-ビス(4-アミ ノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノ キシ)フェニル] ヘキサフルオロプロパン、1,5-ビス(4-アミノフェニ

ル)ペンタン、1, 4-ビス(4-アミノフェニル)ブタン、1, 3-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、ジ(4-アミノフェニル)ペンタン-1, 5-ジオエート、ジ(4-Pミノフェニル)ヘキサン-1, 6-ジオエート、ジ(4-Pミノフェニル)ヘプタン-1, 7-ジオエート等の芳香族または芳香族含有ジアミン化合物が挙げられる。また、プレチルト角を高める目的で、4, $4^{\prime}-ジ$ アミノ-3-Fデシルジフェニルエーテル、1-Fデシルオキシ-2, 4-ジアミノベンゼン等に代表される長鎖アルキル基を有するジアミンを使用することもできる。これらの2種類以上の混合物を使用することもできる。

上記一般式(19a)および(19b)中のR¹²及びR¹³に対応するアミノカルボン酸成分を構築するためのモノマー化合物の具体例としては、m-アミノ安息香酸、p-アミノ安息香酸、4-メチル-m-アミノ安息香酸、3-メチル-p-アミノ安息香酸、2-アミノ-6-カルボキシナフタレン、1-アミノ-5-カルボキシナフタレン、1-アミノ-6-カルボキシアントラセン、2-アミノ-7-カルボキシアントラセン、4-(4-アミノフェニル)安息香酸、3-(4-アミノフェニル)安息香酸、4-(3-アミノフェニル)安息香酸、4-(3-アミノフェノキシ)安息香酸、4-アミノフェノキシ)安息香酸、4-アミノフェノキシ)安息香酸、4-アミノー4'-カルボキシベンゾフェノン、3-アミノー4'-カルボキシベンゾフェノン、4-アミノ-3'-カルボキシベンゾフェノン、4-(4-アミノ-3-メチルフェニル)の-トルイル酸、4-(4-アミノ-2-メチルフェニル)の-トルイル酸、4-アミノフェニルン4-カルボキシフェニルメタン、3-アミノフェニルー4-カルボキシフェニルメタン、3-アミノフェニルー4-カルボキ

シフェニルメタン、4ーアミノフェニルー3-カルボキシフェニルメタン、4-アミノー4^-カルボキシジフェニルメタン、4-アミノフェニル-4-カルボ キシフェニルスルホン、3-アミノフェニル-4-カルボキシフェニルスルホン、 4-アミノフェニルー3-カルボキシフェニルスルホン、2,2-(4-アミノ フェニルー4ーカルボキシフェニル)プロパン、2,2-(3-アミノフェニル -4-カルボキシフェニル)プロパン、2,2-(4-アミノフェニル-3-カ ルボキシフェニル)プロパン、4-アミノフェニル-4-カルボキシベンズアニ リド、3-アミノ-4^-カルボキシベンズアニリド、4-アミノ-3^-カル ボキシベンズアニリド、4-[3-(4-アミノフェノキシ)フェノキシ]安息 香酸、4-[4-(4-アミノフェノキシ)フェノキシ]安息香酸、1-(4-アミノベンズアミド)-3-(4-カルボキシベンズアミド)ベンゼン、1-(4-アミノベンズアミド)-4-(4-カルボキシベンズアミド)ベンゼン、 4- [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] 安息香酸、4- [4- {4-(4-アミノフェノキシ) フェニル} フェノキシ] 安息香酸、4- [4- [2-【4- (4-アミノフェノキシ) フェニル】イソプロピリデン] フェノキシ] 安 息香酸、4-〔4-〔2-{4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〉ヘキサフ ルオロイソプロピリデン]フェノキシ]安息香酸、4-〔4-(4-アミノフェ ノキシ)ブトキシ] 安息香酸、4-[5-(4-アミノフェノキシ) ペンチロキ シ〕安息香酸、4-[6-(4-アミノフェノキシ)ヘキシロキシ]安息香酸、 4-[5-(4-アミノフェノキシ)-1,5-ジオキソペンチル]安息香酸、 4-[6-(4-アミノフェノキシ)-1,6-ジオキソヘキシル]安息香酸、 4-[7-(4-アミノフェノキシ)-1, 7-ジオキソヘプチル] 安息香酸等 の芳香族または芳香族含有アミノカルボン酸、更には3-アミノシクロヘキサン カルボン酸、4-アミノシクロヘキサンカルボン酸、1-アミノシクロブタンカ ルボン酸、2-アミノシクロブタンカルボン酸、4-(4-アミノシクロヘキシ ルメチル)シクロヘキサンカルボン酸、4- (4-アミノ-3-メチルシクロヘ キシルメチル)-3ーメチル-シクロヘキサンカルボン酸、4-(4-アミノシ クロヘキシロキシ)シクロヘキサンカルボン酸、4-(4-アミノー3-メチル シクヘキシロキシ)-3-メチルーシクロヘキサンカルボン酸等の脂環式アミノ

カルボン酸が挙げらる。また、これらの2種類以上の混合物を使用することもできる。

更に、光反応の感度の観点および原料の入手し易さ等から、p-アミノ安息香酸、m-アミノ安息香酸、メチル-p-アミノ安息香酸、4-メチル-m-アミノ安息香酸、4-メチル-m-アミノ安息香酸、4-(4-アミノフェノキシ)安息香酸、3,3'-ジメチル-4-(4'-アミノフェニル)安息香酸、4-(4-アミノフェニル)安息香酸、(4-アミノフェニル)安息香酸、(4-アミノフェニル-4'-カルボキシフェニル)メタン、3,3'-ジメチル-(4-アミノフェニル-4'-カルボキシフェニル)メタン、4-アミノフェニル-4-カルボキシフェニルスルホン等のアミノカルボン酸化合物を使用することが好ましい。

アミド基の両端に2価または3価の芳香族基が直接結合するか、または上記結合の片端に2価または3価の芳香族基が直接結合しかつもう一方の片端に2価または3価の脂環式炭化水素基が直接結合する構造を含有する繰り返し単位は液晶の配向安定性の観点から全ポリマー成分の20~100モル%含むことが好ましく、50~100モル%が更に好適である。

また、本発明に係る高分子化合物としてのポリアミドは、アミド基の両端に2 価または3価の芳香族基が直接結合するか、または上記結合の片端に2価または 3価の芳香族基が直接結合しかつもう一方の片端に2価または3価の脂環式炭化 水素基が直接結合する構造を含有していればよく、芳香族基または脂環式炭化水 素基を有しないジカルボン酸、ジアミン、アミノカルボン酸でも上記の成分と組 み合わせることにより併用することもできる。敢えてその具体例をあげるならば、 ジカルボン酸成分として、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピ ン酸、ピメリン酸、スペリン酸、マゼライン酸、セバチン酸、1,9ーノナンジ カルボン酸、1,10ーデカンジカルボン酸等のジカルボン酸及びこれらの酸ハ ロゲン化物、酸無水物並びにアルキルエステル化物等が挙げられ、またこれらの 2種以上の混合物を使用することもできる。更に、ジアミン成分としては、1, 2ージアミノエタン、1,3ージアミノプロバン、1,4ージアミノブタン、1, 5ージアミノペンタン、1,6ージアミノヘキサン、1,7ージアミノヘプタン、 1,8ージアミノオクタン、1,9ージアミノノナン、1,10ージアミノデカ

ン等の脂肪族ジアミン、更には、m-キシリレンジアミン、 p-キシリレンジア ミンまたは、

(式中、mは1~10の整数を表す。)

等のジアミノシロキサンが挙げられる。これらのジアミン成分の1種類または2種類以上を混合して使用することもできる。

また、アミノカルボン酸成分としては、3-アミノプロピオン酸、4-アミノ 酪酸、5-アミノペンタン酸、6-アミノヘキサン酸、7-アミノヘプタン酸、 8-アミノオクタン酸、9-アミノノナン酸、10-アミノデカン酸、11-ア ミノウンデカン酸等の脂肪族アミノカルボン酸成分が挙げられ、これらのアミノ カルボン酸成分の2種類以上を混合して使用することもできる。

このようなポリアミドの合成法は特に限定されるものではない。一般にはジカルボン酸またはその誘導体とジアミンを等モル量仕込み、有機溶剤中で重縮合反応を行うか、または1種類のアミノカルボン酸の重縮合反応または2種類以上のアミノカルボン酸の共重合反応を行うことによって得ることができる。

これらの重縮合反応は縮合剤の存在下好適に進行するが、ここで用いられる縮合剤としては、モノマーとしてジカルボン酸またはアミノカルボン酸を用いる場合には、亜リン酸トリフェニル、テトラクロロシラン、ジメチルクロロシラン等を、モノマーとしてジカルボン酸ハロゲン化物を用いる場合には、トリメチルアミン、ピリジン、N, N-ジメチルアニリン等を例示することができる。

また、この反応は有機溶媒中で行うことが好ましく、使用される溶媒の具体例としては、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルー2-ピロリドン、N-メチルカプラクタム、テトラヒドロフラン、ジオキサン、トルエン、クロロホルム、ジメチルスルホキシド、テトラメチル尿素、ピリジン、ジメチルスルホン、ヘキサメチルホスホルアミド、及びブチルラクトン、クレゾール等を挙げることができる。

この縮合反応に於ける反応温度は、通常−100℃から200℃程度の温度範

囲が好ましい。

一方、モノマーとして上記のジカルボン酸無水物またはアルキルエステル化合物を用いる場合には、一般に上記の縮合剤及び溶媒を用いずに、ジアミン化合物を混合し、真空中、加熱溶解することにより好適に重縮合反応が進行する。

以上述べたような製造方法により得られるポリアミドの数平均分子量は1000~30000であることが重要であり、より好ましくは3000~30000であることがポリマーの特性を生かす上で好ましい。分子量はゲルパーミエーションクロマトグラフィー、浸透圧法、光分散法、粘度法等の公知の方法により測定される。

また、ポリアミド塗膜を形成する際には通常は上記重合溶液をそのまま基板に 塗布し、基板上で加熱してポリアミド塗膜を形成することができる。また、生成 したポリアミド溶液を大過剰の水、メタノールのごとき貧溶媒中に投入し、沈殿 回収した後に溶媒に再溶解して用いてもよい。上記ポリアミド溶液の希釈溶液及 び/または沈殿回収したポリアミドの再溶解溶媒は、ポリアミドを溶解するもの であれば特に限定されない。

それらの溶媒の具体例としては、2-ピロリドン、Nーメチルピロリドン、Nーエチルピロリドン、Nービニルピロリドン、N, Nージメチルアセトアミド、N, Nージメチルホルムアミド、アーブチルラクトン等を挙げることができる。これらは単独でまたは混合して使用してよい。更に、単独では均一溶液が得られない溶媒であっても、均一溶液が得られる範囲でその溶媒を加えて使用してもよい。その例としては、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、エチルカルビトール、エチレングリコール等が挙げられる。

この溶液を基板上に塗布し、溶媒を蒸発させることにより基板上にボリアミド 被膜を形成させることができる。この際の温度は溶媒が蒸発すれば十分であり、 通常は80~200℃が好ましい。

上記のようにして得られた本発明の液晶配向処理剤溶液を、スピンコート、転 写印刷法等の方法を用いて基板上に塗布し、これを上記の条件で加熱焼成して高 分子薄膜を形成する。この際の高分子薄膜の厚みとしては、特に限定されるもの

ではないが、通常の液晶配向膜として使用される上で10~3000nmが適当である。

次いで、該高分子薄膜表面に光または電子線が照射される。使用する光の波長としては特に限定されないが、一般には100nm~400nmの範囲であることが好ましく、更に好ましくは、使用する高分子の種類によってフィルター等を介して適宜波長を選択することが好ましい。また、光の照射時間は、一般には数秒から数時間の範囲であるが、使用する高分子により適宜選択することが可能である。

更に、光を照射する方法は特に限定されないが、偏光を用いることが均一な液晶配向を得る上で好ましい。この場合、偏光した紫外線を照射する方法は特に限定されない。偏光面を回転させて照射してもよく、また偏光紫外線の入射角を変えて2回以上照射してもよい。また、実質的に偏光が得られればよく、無偏光の紫外線を基板の法線から一定角度傾けて照射してもよい。

このようにして偏光した紫外線を照射した2枚の基板を作成した後、膜面を互いに対向させ液晶を狭持することにより液晶分子を配向させることができ、且つその配向は熱的にも安定である。

本発明に係る高分子化合物として、更に下記一般式 (42a)及び (42b)

(R²⁶は4価の有機基を表し、R²⁶は3価の有機基を表し、R²⁷は2価または 3価の芳香族基または脂環式炭化水素基と結合したアミド基を含有する2価の有 機基を表す。)

で示されるポリイミド前駆体及びそれを化学的または熱的にイミド化して得られるポリイミドを他の好適な例として挙げることができる。

また、上記一般式 (42a) 及び (42b) 中のR²⁷が下記一般式 (43) ~ (48)

 $(X^{12} \sim X^{30}$ はそれぞれ独立に単結合、O、CO2、OCOまたはCH2Oを表し、R28~R46はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、C1~C24のアルキル基、

 $C_1 \sim C_{24}$ の含フッ素アルキル基、アリル基、プロパルギル基、フェニル基または置換フェニル基を表し、R $^{*5} \sim$ R *15 はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリル基またはプロパルギル基を表し、Y 8 及びY 9 はO、S、SO $_2$ 、CH $_2$ 、NH、NHCOまたはCONHを表し、m 1 は1~4の整数を表す。ただし、R $^{28} \sim$ R 46 が水素原子またはハロゲン原子である場合には、X $^{12} \sim$ X 30 は単結合である。)

で表される基から選ばれるものであることがより好ましい。

上記一般式中の $R^{28} \sim R^{46}$ の $C_1 \sim C_{24}$ のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、iープロピル、ブチル、iーブチル、Sーブチル及びtーブチル等の低級アルキル基に加え、通常用いられる長鎖アルキル基及びシクロヘキシル基、ビシクロヘキシル基等の脂環式炭化水素基を含むアルキル基が挙げられる。 $C_1 \sim C_{24}$ の含フッ素アルキル基としては、トリフルオロメチル、2, 2, 2 - トリフルオロエチル、ペルフルオロエチル、3, 3, 3 - トリフルオロプロピル、ペルフルオロブロピル、ヘキサフルオローiープロピル、3, 3, 4, 4, 4 - ペンタフルオロブチル及びペルフルオロブチル等の低級含フッ素アルキル基に加え、通常用いられる長鎖含フッ素アルキル基が挙げられる。また、置換フェニル基における置換基としては、ハロゲン原子、アルキル基、含フッ素アルキル基、アルコキシ基、含フッ素アルコキシ基、アルコキシカルボニル基等が挙げられる。

上記一般式中、R^{as}~R^{als}で表される基は前記一般式(1)中のR^lで表される基と同様である。R^{as}~R^{als}で表される基が水素原子以外の基を含む上記ポリイミド前駆体及びポリイミドは、以下に例示するジアミンモノマー化合物のアミド基のN位にあらかじめ所望の置換基を導入し、得られた化合物をモノマーとして用いて重合反応を行うことにより製造することができる。

また、 R^{27} の更に好ましい例として、下記式(49)~(56)

(式(5 1)中のR"はハロゲン原子、 $C_1 \sim C_1$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_1$ のアルコキシ基または $C_1 \sim C_1$ のアルコキシカルボニル基を表す。)で表される基が挙げられる。

上記式(51)中のR"のC₁~C₁のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、i-プロピル、ブチル、i-ブチル、s-ブチル及びt-ブチル等の低級アルキル基に加え、通常用いられる長鎖アルキル基、及びシクロヘキシル基、ビシクロヘキシル基等の脂環式炭化水素基を含むアルキル基が挙げられる。C₁

~Cnのアルコキシ基としては、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、iープロポキシ、ブトキシ、iーブトキシ、sーブトキシ及びtーブトキシ等に加え、長鎖アルコキシ基及びシクロヘキシル基、ビシクロヘキシル基等の脂環式炭化水素基を含むアルコキシ基が挙げられる。Cn~Cnのアルコキシカルボニル基としては、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロポキシカルボニル、iープロポキシカルボニル、ブトキシカルボニル、iーブトキシカルボニル、sーブトキシカルボニル及びtーブトキシカルボニルに加え、長鎖アルキコキシカルボニル基、及びシクロヘキシル基、ビシクロヘキシル基等の脂環式炭化水素基を含むアルコキシカルボニル基が挙げられる。

上記一般式(42a)中のR26に対応するテトラカルボン酸成分を構築するた めのモノマー化合物の具体例としては、1、2、3、4ーシクロブタンテトラカ ルボン酸、1, 2, 3, 4-20ロペンタンテトラカルボン酸、2, 3, 4, 5 ーテトラヒドロフランテトラカルボン酸、1,2,4,5-シクロヘキサンテト ラカルボン酸、1-(3,4-ジカルボキシシクロヘキシル)コハク酸、3,4 - ジカルボキシ-1, 2, 3, 4-テトラヒドロ-1-ナフタレンコハク酸、ピ ロメリット酸、2,3,6,7-ナフタレンテトラカルボン酸、1,2,5,6 - ナフタレンテトラカルボン酸、1,4,5,8-ナフタレンテトラカルボン酸、 2, 3, 6, 7-アントラセンテトラカルボン酸、1, 2, 5, 6-アントラセ ンテトラカルボン酸、3,3′,4,4′-ビフェニルテトラカルボン酸、2, 3, 3′, 4′-ビフェニルテトラカルボン酸、ビス (3, 4-ジカルボキシフ ェニル) エーテル、3, 3′, 4, 4′-ベンゾフェノンテトラカルボン酸、ビ ス(3, 4-ジカルボキシフェニル)スルホン、ビス(3, 4-ジカルボキシフ ェニル)メタン、2,2ービス(3,4ージカルボキシフェニル)プロパン、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2, 2-ビス(3, 4-ジカルボキシフ ェニル)プロパン、ビス(3、4-ジカルボキシフェニル)ジメチルシラン、ビ ス(3、4-ジカルボキシフェニル)ジフェニルシラン、2,3,4,5-ピリ ジンテトラカルボン酸及びこれらの2無水物並びにこれらのジカルボン酸ジ酸ハ ロゲン化物、1,2,3,4-ブタンテトラカルボン酸等の脂肪族テトラカルボ ン酸及びこれらの2無水物並びにこれらのジカルボン酸ジ酸ハロゲン化物等が挙

げられる。また、これらのテトラカルボン酸及びその誘導体の1種または2種以上を混合して使用することもできる。

上記一般式(42b)中のR²⁶に対応するトリカルボン酸成分を構築するた めのモノマー化合物の具体例としては、1,2,3-シクロブタントリカルボン 酸、1、2、3-シクロペンタントリカルボン酸、1、2、4-シクロペンタン トリカルボン酸、2,3,4ーテトラヒドロフラントリカルボン酸、2,3,5 ーテトラヒドロフラントリカルボン酸、1,2,4-シクロヘキサントリカルボ ン酸、1-(3-カルボキシシクロヘキシル)コハク酸、1-(4-カルボキシ シクロヘキシル)コハク酸、トリメリット酸、2,3,6-ナフタレントリカル ボン酸、1,2,5-ナフタレントリカルボン酸、1,2,6-ナフタレントリ カルボン酸、1,4,8-ナフタレントリカルボン酸、2,3,6-アントラセ ントリカルボン酸、1,2,5-アントラセントリカルボン酸、4-(3,4-ジカルボキシフェニル)安息香酸、3-(3,4-ジカルボキシフェニル)安息 香酸、4-(3,4-ジカルボキシフェノキシ)安息香酸、3-(3,4-ジカ ルボキシフェノキシ)安息香酸、3,4,4′-ベンゾフェノントリカルボン酸、 4-カルボキシフェニル-3 $^{\prime}$, 4^{\prime} -ジカルボキシフェニルスルホン、4-カ ルボキシフェニル-3′, 4′-ジカルボキシフェニルメタン、及びこれらの無 水物並びにこれらのジカルボン酸酸ハロゲン化物、1,2,4-ブタントリカル ボン酸等の脂肪族トリカルボン酸及びこれらの酸無水物並びにこれらのジカルボ ン酸酸ハロゲン化物等が挙げられる。また、これらのトリカルボン酸及びその誘 導体の1種または2種以上を混合して使用することもできる。

上記一般式 (42a) 及び (42b) 中の R^{27} のジアミン成分を構築するため のモノマー化合物の具体例としては、4, 4 ' - ジアミノベンズアニリド、3, 4 ' - ジアミノベンズアニリド、1, 3 - ジ [4 - アミノベンズアミド] ベンゼン、1, 4 - ジ [4 - アミノベンズアミド] ベンゼン、及び下記式で表されるジアミン成分等が挙げられる。

また、これらのジアミン成分の2種類以上を混合して使用することもできる。 更に液晶配向の安定性の観点から、4,4′-ジアミノベンズアニリド、1, 3-ジ [4-アミノベンズアミド] ベンゼン、及び下記式で示されるジアミン成



分を含有することが好ましい。

以上のアミド基の両端に2価または3価の芳香族基が直接結合するか、または

片端に2価または3価の芳香族基が直接結合しかつもう一方の片端に2価または3価の脂環式炭化水素基が直接結合する構造を含有する繰り返し単位は、液晶の配向安定性の観点から全ポリマー成分の20~100モル%含むことが好ましく、50~100モル%が更に好適である。

更に、本発明の効果を発現しうる範囲であれば、一般的にポリイミド合成に使用されるジアミン成分を使用することもできる。その具体例を挙げるならば、p ーフェニレンジアミン、m ーフェニレンジアミン、2 , 5 ージアミノトルエン、2 , 6 ージアミノトルエン、4 , 4 ' ージアミノピフェニル、3 , 3 ' ージメチルー4 , 4 ' ージアミノピフェニル、3 , 3 ' ージアミノピフェニル、4 , 4 ' ージアミノジフェニルメタン、4 , 4 ' ージアミノジフェニルエーテル、4 , 4 ' ージアミノジフェニルコーテル、4 , 4 ' ージアミノジフェニルンカン、4 , 4 ' ージアミノジフェニルスルホン、4 , 4 ' ージアミノベンゾフェノン、4 , 4 ' ージアミノナフタレン、4 , 4 ' ージアミノベンゾフェノン、4 , 4 ' ージアミノヴンン、4 , 4 ' ージアミノベンゾフェノン、4 , 4 ' ージアミノウン、4 , 4 ' ージアミノベンゾフェノン、4 , 4 ' ージアミノベンゾフェノン、4 , 4 ' ージアミノヴンン、4 , 4 ' ージアミノベンゾフェノン、4 , 4 ' ージアミノヴンン、4 , 4 ' ージアミノベンゾフェノン、4 , 4 ' ージアミノベンゾフェノン、4 , 4 ' ージアミノベンゾフェノン、4 , 4 ' ージアミノヴンン、4 , 4 ' ージアミノベンゾフェノン、4 , 4 ' ージアミノヴンン、4 , 4 ' ージアミノベンゾフェノン、4 , 4 ' ージアミノウンン、4 , 4 ' ージアミノベンゾフェノン、4 , 4 ' ージアミノウンン、4 , 4 ' ージアミノヴンン、4 , 4 ' ージアミノヴンソフェール

 $4-\forall X$ ($4-\gamma = 1/\gamma =$

$$H_2N - (CH_2)_3 - (Si - O)_m - Si - (CH_2)_3 - NH_2$$

(式中、mは1~10の整数を表す。)

等のジアミノシロキサンが挙げられる。

また、プレチルト角を高める目的で、4, 4 $^{\prime}$ $^{\prime}$

このようなポリイミドの製造方法は特に限定されるものではない。一般にはテトラカルボン酸及びそのその誘導体とジアミンを反応・重合させポリイミド前駆体とした後、これを閉環イミド化するが、この際用いるテトラカルボン酸及びその誘導体としてはテトラカルボン酸二無水物を用いるのが一般的である。テトラカルボン酸二無水物のモル数とジアミンの総モル数との比は 0.8 から 1.2 であることが好ましい。通常の重縮合反応同様、このモル比が 1 に近いほど生成する重合体の重合度は大きくなる。

重合度が小さすぎると配向膜として使用する際にポリイミド膜の強度が不十分で、液晶の配向が不安定になる。また、重合度が大きすぎるとポリイミド膜形成時の作業性が悪くなる場合がある。従って、本反応に係るポリイミド前駆体の数平均分子量は1000~30000であることが重要であり、より好ましくは300~30000であることがポリマーの特性を生かす上で好ましい。分子量はゲルパーミエーションクロマトグラフィー、浸透圧法、光分散法、粘度法等の公知の方法により測定される。

テトラカルボン酸二無水物とジアミンの反応・重合させる方法は、特に限定されるものではなく、一般的にはN-メチル-2-ピロリドン、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド等の有機極性溶媒中で1級ジアミンとテトラカルボン酸二無水物を反応させてポリイミド前駆体を合成した後、脱水閉環イミド化する方法がとられる。

テトラカルボン酸及びその誘導体とジアミンの反応重合温度は-20~150 ℃の任意の温度を採用することができるが、特に-5~100℃の範囲が好ましい。更に、このポリイミド前駆体を100~400℃で加熱脱水するか、または 通常用いられているトリエチルアミン/無水酢酸等のイミド化触媒を用いて化学 的イミド化を行うことにより、イミド化することができる。

また、ポリイミド塗膜を形成する際には通常はポリイミド前駆体溶液をそのまま基板に塗布し、基板上で加熱イミド化してポリイミド塗膜を形成することができる。この際に用いられるポリイミド前駆体溶液は、上記重合溶液をそのまま用いてもよく、また、生成したポリイミド前駆体溶液を大過剰の水、メタノールのごとき貧溶媒中に投入し、沈殿回収した後に溶媒に再溶解して用いてもよい。上記ポリイミド前駆体溶液の希釈溶液及び/または沈殿回収したポリイミド前駆体の再溶解溶媒は、ポリイミド前駆体を溶解するものであれば特に限定されない。

それらの溶媒の具体例としては、N-メチル-2-ピロリドン、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド等を挙げることができる。これらは単独でまたは混合して使用してよい。更に、単独では均一溶液が得られない溶媒であっても、均一溶液が得られる範囲でその溶媒を加えて使用してもよい。その例としては、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、エチルカルビトール、

ブチルカルビトール、エチルカルビトールアセテート、エチレングリコール等が 挙げられる。

また、基板上で加熱イミド化させる温度は100~400℃の任意の温度を採用することができるが、特に150~350℃の範囲が好ましい。

一方、ポリイミドが溶媒に溶解する場合には、テトラカルボン酸二無水物とジアミンを反応させて得られたポリイミド前駆体溶液を溶液中でイミド化し、ポリイミド溶液とすることができる。

このようにして得られたポリイミド溶液はそのまま使用することもでき、また、 メタノール、エタノール等の貧溶媒に沈殿させ、単離した後、適当な溶媒に再溶 解させて使用することもできる。

再溶解させる溶媒は、得られたポリイミドを溶解するものであれば特に限定されないが、その例としては、2-ピロリドン、N-メチル-2-ピロリドン、N-エチルピロリドン、N-ビニルピロリドン、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、 $\gamma-$ ブチルラクトン等を挙げることができる。

その他、単独ではポリイミドを溶解させない溶媒であっても溶解性を損なわない範囲であれば上記溶媒に加えてもかまわない。均一溶液が得られない溶媒であっても、均一溶液が得られる範囲でその溶媒を加えて使用してもよい。その例としては、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、エチルカルビトールアセテート、エチレングリコール等が挙げられる。

この溶液を基板上に塗布し、溶媒を蒸発させることにより基板上にポリイミド 被膜を形成させることができる。この際の温度は溶媒が蒸発すれば十分であり、 通常は80~200℃が好ましい。

上記のようにして得られた本発明の液晶配向処理剤溶液を、スピンコート、転写印刷法等の方法を用いて基板上に塗布し、これを上記の条件で加熱焼成して高分子薄膜を形成する。この際の高分子薄膜の厚みとしては、特に限定されるものではないが、通常の液晶配向膜として使用される上で10~3000nmが適当である。

次いで、該高分子薄膜表面に、光または電子線が照射される。使用する光の波

長としては特に限定されないが、一般には100nm~400nmの範囲であることが好ましく、更に好ましくは、使用する高分子の種類によってフィルター等を介して適宜波長を選択することが好ましい。また、光の照射時間は、一般には数秒から数時間の範囲であるが、使用する高分子により適宜選択することが可能である。

更に、光を照射する方法は特に限定されないが、偏光を用いることが均一な液晶配向を得る上で好ましい。更に、偏光した紫外線を照射する方法は特に限定されない。偏光面を回転させて照射してもよく、また偏光紫外線の入射角を変えて2回以上照射してもよい。また、実質的に偏光が得られればよく、無偏光の紫外線を基板の法線から一定角度傾けて照射してもよい。

このようにして偏光した紫外線を照射した2枚の基板を作成した後、膜面を互いに対向させ液晶を狭持することにより液晶分子を配向させることができ、且つその配向は熱的にも安定である。

本発明に係る高分子化合物として、更に下記一般式 (57)

(R4®及びR4®はそれぞれ独立に下記式(58)~(69)

で表される基から選ばれ、R*''及びR*''はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリル基またはプロパギル基を表す。)

で表される繰り返し単位を含むポリウレタンを他の好適な例として挙げることができる。

上記一般式中、R a 16 及びR a 17 で表される基は前記一般式(2)中のR 1 で表される基と同様である。R a 16 及びR a 17 で表される基が水素原子以外の基を含む上記ポリウレタンは、以下に示す方法で得られるR a 16 及びR a 17 で表される基が水素原子であるポリウレタンのウレタン基のN位に既知の高分子反応(モーレイ等、ジャーナル オブ アプライド ポリマー サイエンス、45巻、1983ページ(1992))、高柳等、ジャーナル オブ ポリマー サイエンス、45巻、1983(1992))、高柳等、ジャーナル オブ ポリマー サイエンス、ポリマー ケミストリー エディション、19巻、1133ページ(1981))等参照)を利用して所望の置換基を所望の割合で導入することにより得られる。

上記一般式 (57) 中の R 48 に対応するジイソシアネート成分を構築するためのモノマー化合物の具体例としては、1、3 - フェニレンジイソシアネート、1、4 - フェニレンジイソシアネート、4 - メチル- 1、3 - フェニレンジイソシアネート、5 - メチル- 1、4 - フェニレンジイソシアネート、2、2 - ビス(イソシアネートフェニル)プロパン、4、4 $^{\prime}$ - ジイソシアネートピフェニル、3、3 $^{\prime}$ - ジメチル- 4、4 $^{\prime}$ - ジイソシアネートピフェニル、4、4 $^{\prime}$ - ジイソシ



アネートジフェニルエーテル、3, 4 $^{\prime}$ - ジイソシアネートジフェニルエーテル、4, 4 $^{\prime}$ - ジイソシアネートジフェニルメタン、3, 3 $^{\prime}$ - ジメチルー4, 4 $^{\prime}$ - ジイソシアネートジフェニルメタン、4, 4 $^{\prime}$ - ジイソシアネートジフェニルスルホン、1, 3 - シクロヘキサンジイソシアネート、1, 4 - シクロヘキサンジイソシアネート等を好適な例として挙げられる。また、これらの2 種類以上の混合物を使用することもできる。

一方、上記一般式(57)中のR⁴⁹に対応するジオール成分を構築するためのモノマー化合物の具体例としては、レゾルシノール、ハイドロキノン、4ーメチルレゾルシノール、5ーメチルハイドロキノン、ビスフェノールA、4,4′ービフェノール、3,3′ージメチルー4,4′ービフェノール、4,4′ージヒドロキシジフェニルエーテル、3,4′ージヒドロキシジフェニルエーテル、4,4′ージヒドロキシジフェニルメタン、3,3′ージメチルー4,4′ージヒドロキシジフェニルメタン、1,3 ーシクロヘキサンジオール、1,4ーシクロヘキサンジオール等を好適な例として挙げられる。また、これらの2種類以上の混合物を使用することもできる。

また、本発明に係る高分子化合物としてのポリウレタンは、ウレタン基の両端に2価または3価の芳香族基が直接結合するか、または上記結合の片端に2価または3価の芳香族基が直接結合しかつもう一方の片端に2価または3価の脂環式炭化水素基が直接結合する構造を含有していればよく、芳香族基または脂環式炭化水素基を有しないジイソシアネート化合物、ジオール化合物でも上記の成分と組み合わせることにより併用することもできる。その具体例をあげるならば、ジイソシアネート化合物として、テトラメチレンジイソシアネート、ペンタメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、オクタメチレンジイソシアネート、mーキシリレンジイソシアネート等が挙げられ、またこれらの2種以上の混合物を使用することもできる。更に、ジオール化合物としては、エチレングリコール、トリメチレングリコール、デトラメチレングリコール、ペンタメチレングリコール、ヘキサメチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ハキサメチレングリコール、ジエチレングリコール、ドリエチレングリコール、ローキシリレングリコール、アーキシリレングリコール等が挙げられる。これらのジオール成分の1種類または2種類以上を混合して使用す

ることもできる。

このようなポリウレタンの合成法は特に限定されるものではない。一般にはジイソシアネートとジオールを等モル量仕込み、有機溶媒中で重付加反応を行うことによって得ることができる。これらの重付加反応は触媒の存在下好適に進行するが、ここで用いられる触媒としては、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソブチルアミン、ジブチルアミン、ジエチルアミン、ピリジン、2,6-ジメチルピリジン等を例示することができる。

また、この反応は有機溶媒中で行うことが好ましく、使用される溶媒の具体例としては、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルー2-ピロリドン、N-メチルカプラクタム、テトラヒドロフラン、ジオキサン、トルエン、クロロホルム、ジメチルスルホキシド、テトラメチル尿素、ピリジン、ジメチルスルホン、ヘキサメチルホスホルアミド、ブチルラクトン、クレゾール等を挙げることができる。

この重付加反応に於ける反応温度は、通常-20℃から200℃程度の温度範囲が好ましい。

以上述べたような製造方法により得られるポリウレタンの数平均分子量は1000以上、30000以下であることが重要であり、より好ましくは3000以上、30000以下であることがポリマーの特性を生かす上で好ましい。分子量はゲルパーミエーションクロマトグラフィー、浸透圧法、光分散法、粘度法等の公知の方法により測定される。

また、ポリウレタン塗膜を形成する際には通常は上記重合溶液をそのまま基板に塗布し、基板上で加熱してポリウレタン塗膜を形成することができる。また、生成したポリウレタン溶液を大過剰の水、メタノールのごとき貧溶媒中に投入し、沈殿回収した後に溶媒に再溶解して用いてもよい。上記ポリウレタン溶液の希釈溶液及び/または沈殿回収したポリウレタンの再溶解溶媒は、ポリウレタンを溶解するものであれば特に限定されない。

それらの溶媒の具体例としては、2-ピロリドン、N-メチルー2-ピロリドン、N-エチルピロリドン、N-ビニルピロリドン、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、 $\gamma-$ ブチルラクトン等を挙げることがで

きる。これらは単独でまたは混合して使用してよい。更に、単独では均一溶液が得られない溶媒であっても、均一溶液が得られる範囲でその溶媒を加えて使用してもよい。その例としては、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、エチレングリコール等が挙げられる。

この溶液を基板上で塗布、溶媒を蒸発させることにより基板上にポリウレタン 被膜を形成させることができる。この際の温度は溶媒が蒸発すれば十分であり、 通常は80~200℃が好ましい。

上記のようにして得られた本発明の液晶配向処理剤溶液を、スピンコート、転写印刷法等の方法を用いて基板上に塗布し、これを上記の条件で加熱焼成して高分子薄膜を形成する。この際の高分子薄膜の厚みとしては、特に限定されるものではないが、通常の液晶配向膜として使用される上で10~3000nmが適当である。

次いで、該高分子薄膜表面に光または電子線が照射される。使用する光の波長としては特に限定されないが、一般には $100nm \sim 400nm$ の範囲であることが好ましく、更に好ましくは、使用する高分子の種類によってフィルター等を介して適宜波長を選択することが好ましい。また、光の照射時間は、一般には数秒から数時間の範囲であるが、使用する高分子により適宜選択することが可能である。

更に、光を照射する方法は特に限定されないが、偏光を用いることが均一な液晶配向を得る上で好ましい。この場合、偏光した紫外線を照射する方法は特に限定されない。偏光面を回転させて照射してもよく、また偏光紫外線の入射角を変えて2回以上照射してもよい。また、実質的に偏光が得られればよく、無偏光の紫外線を基板の法線から一定角度傾けて照射してもよい。

このようにして偏光した紫外線を照射した2枚の基板を作成した後、膜面を互いに対向させ液晶を狭持することにより液晶分子を配向させることができ、且つその配向は熱的にも安定である。

本発明に係る高分子化合物として、更に下記一般式 (70)

 $(R^{50}$ 及び R^{51} はそれぞれ独立に上記式(58)~(69)で表される基から選ばれ、 R^{a18} ~ R^{a21} はそれぞれ水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリル基またはプロパルギル基を表す。)

で表される繰り返し単位を含むポリウレアを他の好適な例として挙げることがで きる。

上記一般式中、R^{a18}~R^{a21}で表される基は前記一般式(3)中のR¹及びR²で表される基と同様である。R^{a18}~R^{a21}で表される基が水素原子以外の基を含む上記ポリウレアは、以下に示す方法で得られる。R^{a18}~R^{a21}で表される基が水素原子であるポリウレアのウレア基のN位に既知の高分子反応(モーレイ等、ジャーナル オブ アプライド ポリマー サイエンス、45巻、1983ページ(1992年)(T.H. Mourey et. al., J. Appl. Polym. Sci., 45, 1983 (1992))、高柳等、ジャーナル オブ ポリマー サイエンス、ポリマー ケミストリー エディション、19巻、1133ページ(1981年)(M. Takayanagi et. al., J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed., 19, 1133 (1981))等参照)を利用して所望の置換基を所望の割合で導入することにより得られる。

上記一般式 (70) 中の R 50 に対応するジイソシアネート成分を構築するためのモノマー化合物の具体例としては、1,3-フェニレンジイソシアネート、1,4-フェニレンジイソシアネート、4-メチルー1,3-フェニレンジイソシアネート、5-メチルー1,4-フェニレンジイソシアネート、2,2-ビス(イソシアネートフェニル)プロパン、4,4'-ジイソシアネートジフェニル、3,3'-ジメチルー4,4'-ジイソシアネートジフェニル、4,4'-ジイソシアネートジフェニルエーテル、4,4'-ジイソシアネートジフェニルエーテル、4,4'-ジイソシアネートジフェニルメタン、3,3'-ジメチルー4,4'-ジイソシアネートジフェニルメタン、4,4'-ジイソシアネートジフェニルスルホン、1,3-シクロヘキサンジイソシアネート、1,4-シクロヘキサンジイソシアネート等を好適な例として挙げられる。また、これらの2種類以上の

混合物を使用することもできる。

一方、上記一般式 (70) 中の R ⁵¹ に対応するジアミン成分を構築するためのモノマー化合物の具体例としては、m-フェニレンジアミン、p-フェニレンジアミン、4-メチルーm-フェニレンジアミン、5-メチルーp-フェニレンジアミン、2,2-ビス (4-アミノフェニル)プロパン、4,4′-ジアミンジフェニル、4,4′-ジアミノジフェニル、4,4′-ジアミノジフェニル、4,4′-ジアミノジフェニルエーテル、3,4′-ジアミノジフェニルエーテル、4、4′-ジアミノジフェニルメタン、4,4′-ジアミノ・3,3′-ジメチルジフェニルメタン、4,4′-ジアミノ・3,3′-ジメチルジフェニルメタン、4,4′-ジアミノジフェニルスルホン、1,3-シクロヘキサンジアミン等を好適な例として挙げることができる。また、これらの2種類以上の混合物を使用することもできる。

また、本発明に係る高分子化合物としてのポリウレアは、ウレア基の両端に2 価または3価の芳香族基が直接結合するか、または上記結合の片端に2価または 3 価の芳香族基が直接結合しかつもう一方の片端に2 価または3 価の脂環式炭化 水素基が直接結合する構造を含有していればよく、芳香族基または脂環式炭化水 素基を有しないジイソシアネート化合物、ジアミン化合物でも上記の成分と組み 合わせることにより併用することもできる。その具体例をあげるならば、ジイソ シアネート化合物として、テトラメチレンジイソシアネート、ペンタメチレンジ イソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、オクタメチレンジイソシア ネート、m-キシリレンジイソシアネート等が挙げられ、またこれらの2種以上 の混合物を使用することもできる。更に、ジアミン化合物としては、1,2-ジ アミノエタン、1, 3-ジアミノプロパン、1, 4-ジアミノブタン、1, 5-ジアミノペンタン、1,6-ジアミノヘキサン、1,7-ジアミノヘプタン、1, 8-ジアミノオクタン、1,9-ジアミノノナン、1,10-ジアミノデカン等 の脂肪族ジアミン、更には、m-キシリレンジアミン、p-キシリレンジアミン 等が挙げられる。これらのジアミン成分の1種類または2種類以上を混合して使 用することもできる。

このようなポリウレアの合成法は特に限定されるものではない。一般にはジイ ソシアネートとジアミンを等モル量仕込み、有機溶媒中で重付加反応を行うこと によって得ることができる。使用される溶媒の具体例としては、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、<math>N-メチル-2-ピロリドン、N-メチルカプラクタム、テトラヒドロフラン、ジオキサン、トルエン、クロロホルム、ジメチルスルホキシド、テトラメチル尿素、ピリジン、ジメチルスルホン、ヘキサメチルホスホルアミド、ブチルラクトン、クレゾール等を挙げることができる。

この重付加反応に於ける反応温度は、通常-20℃から150℃程度の温度範囲が好ましい。

以上述べたような製造方法により得られるポリウレアの数平均分子量は1000~30000であることが重要であり、より好ましくは3000~30000であることがポリマーの特性を生かす上で好ましい。分子量はゲルパーミエーションクロマトグラフィー、浸透圧法、光分散法、粘度法等の公知の方法により測定される。

また、ポリウレア塗膜を形成する際には通常は上記重合溶液をそのまま基板に 塗布し、基板上で加熱してポリウレア塗膜を形成することができる。また、生成 したポリウレア溶液を大過剰の水、メタノールのごとき貧溶媒中に投入し、沈殿 回収した後に溶媒に再溶解して用いてもよい。上記ポリウレア溶液の希釈溶液及 び/または沈殿回収したポリウレアの再溶解溶媒は、ポリウレアを溶解するもの であれば特に限定されない。

それらの溶媒の具体例としては、2-ピロリドン、N-メチル-2-ピロリドン、N-エチルピロリドン、N-ビニルピロリドン、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、アーブチルラクトン等を挙げることができる。これらは単独でまたは混合して使用してよい。更に、単独では均一溶液が得られない溶媒であっても、均一溶液が得られる範囲でその溶媒を加えて使用してもよい。その例としては、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、エチルカルビトールアセテート、エチレングリコール等が挙げられる。

この溶液を基板上で塗布、溶媒を蒸発させることにより基板上にポリウレア被膜を形成させることができる。この際の温度は溶媒が蒸発すれば十分であり、通

常は80~200℃が好ましい。

上記のようにして得られた本発明の液晶配向処理剤溶液を、スピンコート、転写印刷法等の方法を用いて基板上に塗布し、これを上記の条件で加熱焼成して高分子薄膜を形成する。この際の高分子薄膜の厚みとしては、特に限定されるものではないが、通常の液晶配向膜として使用される上で10~3000nmが適当である。

次いで、該高分子薄膜表面に光または電子線が照射される。使用する光の波長としては特に限定されないが、一般には100nm~400nmの範囲であることが好ましく、更に好ましくは、使用する高分子の種類によってフィルター等を介して適宜波長を選択することが好ましい。また、光の照射時間は、一般には数秒から数時間の範囲であるが、使用する高分子により適宜選択することが可能である。

更に、光を照射する方法は特に限定されないが、偏光を用いることが均一な液晶配向を得る上で好ましい。この場合、偏光した紫外線を照射する方法は特に限定されない。偏光面を回転させて照射してもよく、また偏光紫外線の入射角を変えて2回以上照射してもよい。また、実質的に偏光が得られればよく、無偏光の紫外線を基板の法線から一定角度傾けて照射してもよい。

このようにして偏光した紫外線を照射した2枚の基板を作成した後、膜面を互いに対向させ液晶を狭持することにより液晶分子を配向させることができ、且つその配向は熱的にも安定である。

発明を実施するための最良の形態

以下に実施例、参考例、及び比較例を挙げ、本発明を更に詳細に説明するが、 本発明はこれらに限定されるものではない。

実施例1~3

WO 00/13058 PCT/JP99/04575 ...

窒素気流下、4-(4-アミノフェノキシ)安息香酸(以下APBAと略す)とm-アミノ安息香酸(以下MABAと略す)をそれぞれ所定のモル比になるように混合し、N-メチルピロリドン(以下NMPと略す)及び総モノマーの1.2当量のピリジン(以下Pyと略す)、更に同じく1.2当量の亜リン酸トリフェニル(以下TPPと略す)を加え、100℃に加熱した後、所定の時間攪拌した。実際に用いた上記のモノマー、試薬及び溶媒の量、及び反応時間を以下の表1に示す。得られた反応溶液にNMPを加え総固形分7%になるよう希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行い、上記構造式PA-1~PA-3で表されるポリアミドをそれぞれ得た。得られたポリアミドの収量、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた数平均分子量及び重量平均分子量を表2に示す。

表 1

実施	APBAの量	MABAの量	Pyの量	TPPの量	NMPの量	反応時間
例	g (mmol)	g (mmol)	m l	m l	ml	hr
1	27.507	16.457	23.29	75.47	146.56	10
	(120)	(120)				
2	0.4814	0.1234	0.29	0.94	1.96	8
	(2.1)	(0.9)				
3	0.5501	0.0823	0.29	0.94	2.12	8
	(2.4)	(0.6)				

表 2

実施例	ポリマー	ポリマー	数平均	重量平均
	の番号	の収量 g	分子量	分子量
1	PA-1	33.28	3.08×10^{4}	5.59×10 ⁴
2	PA-2	0.54	2.11×10 ⁴	3.96×10⁴
3	PA-3	0.55	1.85×10 ⁴	3.87×10⁴

実施例4

空素気流下、APBAO. 92g (4mmol)と4-メチル-m-アミノ安息香酸(以下Me-MABAと略す) 0. 60g (4mmol)をNMPに4. 75mlに溶解し、この溶液にPy0. 78ml及びTPP2. 52mlを加え、100℃に加熱した後19時間攪拌した。得られた反応溶液をNMP11. 6m

1で希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。 上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 PA-4で表される ポリアミド 1 . 49 g を得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求め た PA-4 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 1 . 0.6×1.0 4及び 1 . 8.9×1.0 4であった。

実施例5

H₂N
$$\longrightarrow$$
 COOH + H₂N \bigcirc COOH

TPP/Py
NMP

NMP

N \longrightarrow COOH

N \longrightarrow COOH

PA-5 (x/y=40/60)

アルゴンガス雰囲気下、p-アミノ安息香酸(以下PABAと略す)0.20 g(1.458mmol)とMABA0.30g(2.188mmol)をNMPに1.31mlに溶解し、この溶液にPy0.31ml及びTPP1.00mlを加え、100℃に加熱した後18時間攪拌した。得られた反応溶液をNMP4mlで希釈した後、過剰のメタノール50mlにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式PA-5で表されるポリアミド0.412gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-5の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ6.74×10³及び1.26×10⁴であった。

実施例6

$$H_2N$$
 $COOH$
 H_3C
 $COOH$
 H_3C
 $COOH$
 H_3C
 $COOH$
 H_3C
 H_3C
 H_3C
 H_3C
 H_3C
 H_3C
 H_3C

アルゴンガス雰囲気下、PABAO. 27g(2.0mmol)とMe-MABAO. 30g(2.0mmol)をNMPに1.33mlに溶解し、この溶液にPy0.39ml及びTPP1.26mlを加え、100℃に加熱した後18時間攪拌した。得られた反応溶液をNMP4mlで希釈した後、過剰のメタノール50mlにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式PA-6で表されるポリアミド0.480gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-6の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ7.56×10³及び2.52×10⁴であった。実施例7

アルゴンガス雰囲気下、イソフタル酸ジクロライド 2. 0 3 g (1 0. 0 mm o l) と 4, 4 $^{\prime}$ $^{\prime}$

室温にて30分攪拌した。得られた反応溶液をNMP30mlで希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式PA-7で表されるポリアミド3.85gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-7の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ1.40×10°及び2.90×10°であった。

実施例8

アルゴンガス雰囲気下、イソフタル酸ジクロライド 2. 0 3 g(1 0. 0 mm o 1)と 3, 4 $^{\prime}$ -ジアミノジフェニルエーテル 2. 0 0 g(1 0. 0 mm o 1)をそれぞれ 1. 0 m o 1 $^{\prime}$ $^{\prime}$ 1 の濃度となるように NMPに溶解し、 $^{\prime}$ - 7 8 $^{\prime}$ の温度で混合し凍結させた。次に、室温までゆっくりと加温して溶液を融解させ、室温にて 1 5 分攪拌した。得られた反応溶液を NMP 3 0 m $^{\prime}$ で る釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子を 5 過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 PA $^{\prime}$ 8 で表されるポリアミド 3. 8 2 gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PA $^{\prime}$ 8 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 1. 3 2 × 1 0 $^{\prime}$ 及び 2. 9 8 × 1 0 $^{\prime}$ であった。

実施例9

アルゴンガス雰囲気下、テレフタル酸ジクロライド 2. 0 3 g(1 0. 0 mm o 1)と 3, 4 $^{\prime}$ - $^{\prime}$ $^{\prime$

実施例10

窒素気流下、4,4′-ジカルボキシジフェニルエーテル1.29g(5.0 mmol)とm-フェニレンジアミン0.54g(5.0 mmol)をNMP5.5 mlに溶解し、この溶液にPy0.97ml及びTPP3.14mlを加え、80℃に加熱した後6時間攪拌した。得られた反応溶液をNMP14mlで希釈

した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ上記構造式 PA-10で表されるポリアミド1.72gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PA-10の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ1.32×10 4 及び2.88×10 4 であった。

実施例11

HOOC
$$\longrightarrow$$
 COOH + H_2N \longrightarrow NH_2 CH_3

TPP/PY $\stackrel{\square}{C}$ $\stackrel{\square}{$

実施例12



アルゴンガス雰囲気下、イソフタル酸ジクロライド 2. 0 3 g(1 0. 0 mm o 1)と 4, 4 $^{\prime}$ $^{\prime}$

実施例13

アルゴンガス雰囲気下、イソフタル酸ジクロライド 2. 0 3 g(1 0. 0 mm o 1)と 4 , 4 $^{\prime}$ $^{\prime}$

実施例14

アルゴンガス雰囲気下、イソフタル酸ジクロライド 2.03g(10.0mm o 1)と 4,4 $^{\prime}$ $^{\prime}$

実施例15

アルゴンガス雰囲気下、イソフタル酸ジクロライド4.06g(20.0mm o 1) と3,3 $^{\prime}$ - ジメチルー4,4 $^{\prime}$ - ジアミノビフェニル4.25g(20.



0 mmol) をそれぞれ1. 0 mol / 1 の濃度となるようにNMPに溶解し、-78%の温度で混合し凍結させた。次に、室温までゆっくりと加温して溶液を融解させ、室温にて30 分攪拌した。得られた反応溶液をNMP64m1で希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式PA-15で表されるポリアミド7. 65 gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-15の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ6. 67×10^3 及び1. 23×10^4 であった。

実施例16

アルゴンガス雰囲気下、テレフタル酸ジクロライド 2. 0 3 g(1 0. 0 mm o 1)と 2, 2 ー ビス [4-(4-r)] フェノキシ)フェニル] プロパン 4. 1 0 g(1 0. 0 mm o 1)をそれぞれ 1. 0 m o 1 / 1 の濃度となるように NMPに溶解し、-78 $\mathbb C$ の温度で混合し凍結させた。次に、室温までゆっくりと加温して溶液を融解させ、室温にて 1 時間攪拌した。得られた反応溶液を NMP 4 7 m 1 で希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 PA -16 で表されるポリアミド 5. 5 8 gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PA -16 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 4. 4 2 × 10 4 及び 8. 17×10 4 であった。

実施例17

アルゴンガス雰囲気下、テレフタル酸ジクロライド 2. 0 3 g(1 0. 0 mm o 1)と 4-メチルーm-フェニレンジアミン 1. 2 2 g(1 0. 0 mm o 1)をそれぞれ 1. 0 m o 1 / 1 の濃度となるように NMPに溶解し、-7 8 $^{\circ}$ の温度で混合し凍結させた。次に、室温までゆっくりと加温して溶液を融解させ、室温にて 1 時間攪拌した。得られた反応溶液を NMP 2 5 m 1 で希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 PA-17で表されるポリアミド 2. 99 gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PA-17の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 9. 3 3×10^3 及び 1. 7.4×10^4 であった。

実施例18

PA-18



溶解し、-7.8 $\,^\circ$ の温度で混合し凍結させた。次に、室温までゆっくりと加温して溶液を融解させ、室温にて3.0 分攪拌した。得られた反応溶液をNMP3.0 m 1 で希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 PA-1.8 で表されるポリアミド 3.7.3 g を得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PA-1.8 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ $5.0.4 \times 1.0.3$ 及び $8.6.1 \times 1.0.3$ であった。

実施例19

参考例1

ジメチル5-ヒドロキシイソフタル酸2.400g(11.42mmo1)、3-ブロモプロペン1.4g(11.6mmo1)および炭酸カリウム1.6g(11.6mmo1)をアセトン40mLに分散し、還流温度で15時間撹拌した。室温まで冷却後、ジエチルエーテル150mLを加えて不溶の塩を炉別した。炉液を濃縮しシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:ジエチルエーテル/ヘキサン=1/2)で精製したところ、上記構造式1で表されるジメチル5-アリロキシイソフタル酸2.612gを無色固体粉末として得た(収率:94.1%)。

IR (KBr, cm⁻¹): 2955 (w), 1736 (s), 1595 (w), 1458 (w), 1437 (w), 1341, 1318 (w), 1252 (s), 1115 (w), 1044, 1011 (w), 928 (w), 876 (w), 756.

¹H-NMR δ (250MHz, CDCl₃, ppm): 3.94 (6H, s), 4.6 (2H, dt), 5.4 (2H, m), 6.0 (1H, m), 7.77 (2H, s), 8.3 (1H, s).

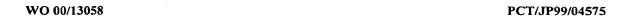
上記の反応で得られたジメチル5-アリロキシイソフタル酸1.109g(4.432mmol)をメタノール50mLに溶解し、ここへ水酸化バリウム(8水和物)2.8g(8.9mmol)を加えて2.5日室温で撹拌した。1N塩酸を加えて酸性化した後、メタノールを留去した。析出物を濾別後水洗し乾燥したところ、上記構造式2で表される5-アリロキシイソフタル酸0.924gを無色粉末として得た。(収率:93.8%)

IR (KBr, cm^{-1}): 3100-2500 (br), 1692 (s), 1592, 1462, 1420, 1316, 1277 (s), 1127 (w), 1038, 939, 912, 762, 694.

¹H-NMR δ (500MHz, Acetone-d₆, ppm): 4.744 (2H, dt, J=1.5, 5.1Hz), 5.299 (1H, dd, J=1.5, 10.6Hz), 5.474 (1H, dd, J=1.7, 17.3Hz), 6.12 (1H, m), 7.787 (2H, d, J=1.4Hz), 8.285 (1H, t), 11.5 (1H, bs).

元素分析結果: (分子式: C11H100s、分子量: 222.20)

計算値(%); C:59.46, H:4.54.



実測値(%); C:59.53, H:4.51.

実施例20

窒素気流下、参考例1で得られた5-アリロキシイソフタル酸0.44g(2.0 mmol)と4,4′-ジアミノジフェニルエーテル0.40g(2.0 mmol)をNMP2.84mlに溶解し、この溶液にPy0.39ml及びTPP1.26mlを加え、100℃に加熱した後6時間攪拌した。得られた反応溶液をNMP6.4mlで希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ上記構造式PA-20で表されるポリアミド0.80gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-20の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ5.99×10³及び1.33×10⁴であった。

実施例21

実施例22

·/ŧ

l

- }

. 1

アルゴンガス雰囲気下、イソフタル酸ジクロライド 2. 0 3 g(1 0. 0 mm o 1)と 3, 3′ -ジメチルー 4, 4′ -ジアミノジフェニルメタン 2. 2 6 g(1 0. 0 mm o 1)をそれぞれ 1. 0 m o 1 / 1 の濃度となるように N M P に溶解し、-7 8 $\mathbb C$ の温度で混合し凍結させた。次に、室温までゆっくりと加温して溶液を融解させ、室温にて 4 時間攪拌した。得られた反応溶液を N M P 3 2 m 1 で希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 P A - 2 2 で表されるポリアミド 3. 9 0 gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた P A - 2 2 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 1. 7 6 × 1 0 4 及び 6. 7 1 × 1 0 4 であった。



実施例23

アルゴンガス雰囲気下、4, 4 $^{\prime}$ - $^{\prime}$ $^{\prime}$ (クロロカルボニル) ジフェニルエーテル 2 . 9 5 g (1 0 . 0 mm o 1) と 3 , 3 $^{\prime}$ - $^{\prime}$ - $^{\prime}$ + $^{\prime}$ - $^{\prime}$ $^{\prime}$

実施例24

アルゴンガス雰囲気下、イソフタル酸ジクロライド 2.03g(10.0mm o 1)、3,3'-ジメチルー4,4'-ジアミノジフェニルメタン1.13g (5.0mm o 1)及び4,4'-ジアミノジフェニルエーテル1.00g(5.

0 mmo 1)をそれぞれ 1.0 mo 1/1 の濃度となるように NMP に溶解し、-78 $\mathbb C$ の温度で混合し凍結させた。次に、室温までゆっくりと加温して溶液を融解させ、室温にて 4 時間攪拌した。得られた反応溶液を NMP31m1 で希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 PA-24 で表されるポリアミド 3.91 gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PA-24 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 1.72×10^4 及び 4.39×10^4 であった。

参考例 2

CIO C
$$\longrightarrow$$
 C O C I $+$ \bigcirc C H $_3$

NMP \bigcirc O $_2$ N \bigcirc NHCO \bigcirc C O NH \bigcirc NO $_2$

CH $_3$ \bigcirc H $_3$ C \bigcirc C O NH \bigcirc NHCO \bigcirc C O NH \bigcirc NH $_2$

EtO H \bigcirc NHCO \bigcirc C O NH \bigcirc NH $_2$

CH $_3$ (I)

2-アミノー4-ニトロトルエン5.16g(3.9mmo1)をNMP10mLに溶解し、水浴にて冷却した。ここへ4,4′-ジ(クロロカルボニル)ジフェニルエーテル5.00g(16.9mmo1)のNMP20mL溶液を20分かけて滴下し、更に室温に戻しながら1時間半撹拌した。この溶液を氷水500mLに投入し、生じた沈殿を回収し、充分に水洗した。この沈殿をNMP20mLとエタノール100mLの混合溶媒中に分散させ80℃で加熱洗浄して濾別したところ、上記構造式3で表される4,4′-ジ[N-(2-メチル-5-ニトロフェニル)カルボニルアミノ]ジフェニルエーテル7.38gを白色粉末として得た(収率:82.7%)。

IR (KBr, cm^{-1}): 3274, 1655 (s), 1595, 1524 (s), 1499, 1476 (w), 1350 (s),

1321, 1252 (s), 1170 (w), 1076 (w), 1013 (w), 885 (w), 822 (w), 739 (w), 658 (w).

¹H-NMR δ (500MHz, DMSO-d₆, ppm): 2.51(6H, s), 7.24 (4H, d, J=8.7Hz), 7.5 8 (2H, d, J=8.5Hz), 8.04 (2H, dd, J=2.4, 8.4Hz), 8.10 (4H, d, J=8.7Hz), 8.35 (2H, d, J=2.3Hz), 10.15 (2H, s).

元素分析結果: (分子式: C28H22N4O7、分子量: 526.50)

計算值(%); C:63.87, H:4.22, N:10.64.

実測値(%); C:63.83, H:4.15, N:10.56.

IR (KBr, cm^{-1}): 3427, 3345, 3275 (br), 1655 (s), 1601, 1586, 1543 (s), 1505 (s), 1493, 1454, 1327 (w), 1281, 1258 (s), 1169, 1107 (w), 1011 (w), 897 (w), 856 (w), 843, 681.

 1 H-NMR δ (500MHz, DMS0-d₆, ppm): 2.06 (6H, s), 4.90 (4H, s), 6.40 (2H, d), J=2.2, 8.1Hz), 6.60 (2H, d, J=2.1Hz), 6.88 (2H, d, J=8.1Hz), 7.17 (4H, d, J=8.7Hz), 8.03 (4H, d, J=8.7Hz), 9.63 (2H, s).

元素分析結果: (分子式: C28H26N4O3、分子量: 466.53)

計算値(%); C:69.68, H:6.28, N:17.41.

実測値(%); C:69.90, H:6.40, N:17.14.

実施例25

アルゴンガス雰囲気下、イソフタル酸ジクロライド1.02g(5.0mmo 1)と参考例2で得られた化合物(I)で表される4,4′ージ [Nー(2ーメチルー5ーアミノフェニル)カルボニルアミノ]ジフェニルエーテル2.33g(5.0mmo 1)をそれぞれ1.0mo 1/1の濃度となるようにNMPに溶解し、-78℃の温度で混合し凍結させた。次に、室温までゆっくりと加温して溶液を融解させ、室温にて4時間攪拌した。得られた反応溶液をNMP25.0mlを加えて希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ上記構造式PA-25で表されるポリアミド3.15gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-25の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ1.61×10 4 及び3.05×10 4 であった。

参考例3

4, 4´ージアミノジフェニルエーテル5.00g(25.0mmol)をNMP30mLに溶解し、水浴にて冷却した。ここへ4-ニトロ安息香酸クロリド9.78g(52.7mmol)のNMP30mL溶液を1時間かけて滴下し、

更に室温に戻しながら2時間撹拌した。この溶液を氷水500mLに投入し、生じた沈殿を回収、充分に水洗した。この沈殿を酢酸エチル/THF混合溶媒で再結晶精製したところ、上記構造式4で表される4,4′-ジ(4-二トロベンズアミド)ジフェニルエーテル11.63gを白色粉末として得た(収率:93.4%)。

IR (KBr, cm⁻¹): 3360, 2924, 1649 (s), 1603 (s), 1539 (s), 1507 (s), 1408 (w), 1350, 1327, 1253, 1225, 1096 (w), 1015 (w), 870, 853, 826, 698 (w). ¹H-NMR δ (500MHz, DMSO-d₆, ppm): 7.06 (4H, d, J=8.9Hz), 7.80 (4H, d, J=8.9), 8.19 (4H, d, J=8.8Hz), 8.38 (4H, d, J=8.8Hz), 10.61 (2H, s).

元素分析結果: (分子式: C26H18N4O7、分子量: 498.45)

計算值(%); C:62.65, H:3.65, N:12.84.

実測値(%); C:62.60, H:3.54, N:12.19.

IR (KBr, cm⁻¹): 3440, 3347, 3288 (br), 3210, 1609 (s), 1570 (w), 1501 (s), 1406, 1310, 1269, 1223 (s), 1182, 876 (w), 841, 766 (w), 689 (w).

¹H-NMR δ (500MHz, DMSO-d₆, ppm): 5.73 (4H, s), 6.59 (4H, d, J=8.6Hz), 6.
96 (4H, d, J=9.0Hz), 7.72 (8H, m), 9.76 (2H, s).

元素分析結果: (分子式: C26H22N4O3、分子量: 438.48)

計算值(%); C:71.21, H:5.07, N:14.60.

実測値(%); C:71.01, H:5.24, N:14.33.

実施例26

アルゴンガス雰囲気下、イソフタル酸ジクロライド1.02g(5.0mmo1)と参考例3で得られた化合物(II)で表される4,4′ージ(4ーアミノベンズアミド)ジフェニルエーテル2.19g(5.0mmo1)をそれぞれ1.0mo1/1の濃度となるようにNMPに溶解し、-78℃の温度で混合し凍結させた。次に、室温までゆっくりと加温して溶液を融解させ、室温にて4時間攪拌した。得られた反応溶液をNMP24.0mlを加えて希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ上記構造式PA-26で表されるポリアミド2.92gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-26の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ1.91×10⁴及び4.08×10⁴であった。実施例27

窒素気流下、1,3-ジカルボキシシクロヘキサン1.72g(10.0mm ol)と4,4'-ジアミノジフェニルエーテル2.00g(10.0mm ol)をNMP24.67mlに溶解し、この溶液にPy3.56ml及びTPP 7.45mlを加え、80℃に加熱した後6時間攪拌した。得られた反応溶液をNMP28mlで希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過

し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 PA-27で表されるポリアミド 3. 15 g を得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PA-27 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 4. 45×10^4 及び 8. 23×10^4 であった。

実施例28

窒素気流下、1, 4-ジカルボキシシクロヘキサン1. 72g(10. 0mm o 1)と3, 4'-ジアミノジフェニルエーテル2. 00g(10. 0mm o 1)をNMP24. 67m1に溶解し、この溶液にPy3. 56m1及びTPP 7. 45m1を加え、80℃に加熱した後6時間攪拌した。得られた反応溶液をNMP28m1で希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式PA-28で表されるポリアミド3. 05gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-28の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ2. 14×10^4 及び4. 35×10^4 であった。

実施例29

窒素気流下、1, 3-ジカルボキシシクロヘキサン0.86g(5.0mmol)、<math>1, 4-ジカルボキシシクロヘキサン0.86(5.0mmol)及び4,

4'-ジアミノジフェニルエーテル2.00g(10.0mmol)をNMP24.67mlに溶解し、この溶液にPy3.56ml及びTPP7.45mlを加え、80℃に加熱した後6時間攪拌した。得られた反応溶液をNMP28mlで希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式PA-29で表されるポリアミド2.98gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-29の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ3.76×10⁴及び5.96×10⁴であった。

実施例30

窒素気流下、1,3-ジカルボキシシクロヘキサン0.86g(5.0mmol)、1,4-ジカルボキシシクロヘキサン0.86(5.0mmol)及び3,4'-ジアミノジフェニルエーテル2.00g(10.0mmol)をNMP24.67mlに溶解し、この溶液にPy3.56ml及びTPP7.45mlを加え、80℃に加熱した後6時間攪拌した。得られた反応溶液をNMP28mlで希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式PA-30で表されるポリアミド2.79gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-30の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ1.87×10 4 及び4.64×10 4 であった。

実施例31

アルゴンガス雰囲気下、実施例1で得られたPA-1、0.30gをジメチルスルホキシド(以下DMSOと略す)6mlに溶解し、この溶液に1N-水酸化カリウムメタノール溶液2mlを加え、室温で1時間撹拌した。その後ヨードメ



タン0. 4m1を加え更に室温で30分攪拌した。得られた反応溶液を過剰のメタノールにあけ析出した高分子を濾過し乾燥したところ、ポリマー0. 27gを得た。得られたポリマーの 1 H-NMRスペクトルを測定したところ、PA-1で表される構造中のアミド基のN位のうち31モル%がメチル基に置換されたポリアミド(以下PA-31と称する)であった。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-31の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ1. 43×10^4 及び2. 96×10^4 であった。

実施例32

実施例33

アルゴンガス雰囲気下、水素化ナトリウム(油性、60%) 1 1 0 mg(2.75 mmol)をDMSO20ml中に分散させ、70℃で1時間撹拌し淡黄色の均一溶液を得た。室温に冷却した後、この溶液に実施例6で得られたポリアミドPA-6、0.86gを加えて溶解させ、更に室温にて4時間撹拌した。次に、ヨードメタン0.5 ml(8.03 mmol)を加え、室温にて更に15時間撹拌し、この溶液を過剰のメタノールにあけ析出した高分子を濾過し乾燥したところ、ポリマー0.69gを得た。得られたポリマーの'H-NMRスペクトルを測定したところ、PA-6で表される構造中のアミド基のN位のうち37モル%がメチル基に置換されたポリアミド(以下、PA-33と称する)であった。また、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-33の数平均分子

量及び重量平均分子量はそれぞれ 6.21×10°及び 9.34×10°であった。 参考例 4

2-アミノトルエン4.788g(44.68mmol)をNMP14mLに溶解し、氷浴にて冷却した。ここへ3,5-ジニトロ安息香酸クロリド10.396g(45.10mmol)のNMP30mL溶液を20分かけて滴下し、更に室温に戻しながら1時間撹拌した。この溶液を水500mLに投入し、生じた沈殿を回収、充分に水洗した。クロロホルム/THF混合溶媒で再結晶精製したところ、上記構造式5で表される3,5-ジニトロー2′-メチルベンズアニリド10.20gを黄色針状結晶として得た(収率:75.8%)。

IR (KBr, cm⁻¹): 3256, 3104, 1649 (s), 1586 (w), 1537 (s), 1491 (w), 1456, 1343 (s), 1312, 1275, 1165 (w), 1076, 914, 762, 729, 706.

¹H-NMR δ (500MHz, DMSO-d₆, ppm): 2.26 (3H, s), 7.25 (2H, m), 7.34 (2H, m), 9.02 (1H, t, J=2.0Hz), 9.17 (2H, d, J=1.9Hz), 10.61 (1H, s).

元素分析結果: (分子式: C14H11N3O5、分子量: 301.25)

計算値(%); C:55.81, H:3.69, N:13.94.

実測値(%); C:55.94, H:3.53, N:13.83.

上記の反応で得られた3,5-ジニトロ-2′-メチルベンズアニリド7.0 0g(23.3mmol)をエタノール200mLおよびTHF150mLの混合溶媒に溶解し、そこへ5%Pd-カーボン粉末0.938gを分散させた。-78℃で充分に減圧脱気した後、系内を水素ガスで置換し温度を室温まで上げて17時間撹拌した。セライトを用いて触媒を除去した後、溶液を濃縮して析出した沈殿を酢酸エチル中に分散させて洗浄し濾別したところ、上記構造式(III)

で表される3, 5-ジアミノ-2'-メチルベンズアニリド5.52gを白色粉末として得た(収率:98.4%)。

IR (KBr, cm^{-1}): 3455, 3401, 3328 (s), 3237 (br), 2924 (s), 2855, 1634 (s), 1593 (s), 1512 (s), 1491 (s), 1368, 1273, 1198, 1117 (w), 992 (w), 839, 758, 683, 610.

¹H-NMR δ (500MHz, DMSO-d₆, ppm): 2.21 (3H, s), 4.91 (2H, s), 5.99 (1H, t, J=1.9Hz), 6.33 (2H, d, J=1.9Hz), 7.11 (1H, m), 7.18 (1H, m), 7.23 (1H, d, J=7.4Hz), 7.32 (1H, d, J=7.3Hz), 9.40 (1H, s).

元素分析結果: (分子式: C14H15N3O、分子量: 241.29)

計算値(%); C:69.68, H:6.28, N:17.41.

実測値(%); C:69.69, H:6.41, N:16.99.

実施例34

アルゴンガス雰囲気下、イソフタル酸ジクロライド1.02g(5.0mmo 1)と参考例4で得られた化合物(III)で表される3,5-ジアミノ-2′-メチルベンズアニリド1.20g(5.0mmo 1)をそれぞれ1.0mo 1/1の濃度となるようにNMPに溶解し、-78℃の温度で混合し凍結させた。次に、室温までゆっくりと加温して溶液を融解させ、室温にて4時間攪拌した。得られた反応溶液をNMP17mlを加えて希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ上記構造式PA-34で表されるポリアミド2.11gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-34の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ2.43×10 4 及び4.45×10 4 であった。

実施例35

アルゴンガス雰囲気下、テレフタル酸ジクロライド1.02g(5.0mmol)と参考例4で得られた化合物(III)で表される3、5-ジアミノ-2'-メチルベンズアニリド1.20g(5.0mmol)をそれぞれ1.0mol/1の濃度となるようにNMPに溶解し、<math>-78℃の温度で混合し凍結させた。次に、室温までゆっくりと加温して溶液を融解させ、室温にて1時間攪拌した。得られた反応溶液をNMP17mlを加えて希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ上記構造式PA-35で表されるポリアミド2.15gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-35の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ1.57×10 4 及び3.63×10 4 であった。

実施例36

アルゴンガス雰囲気下、4, 4 ' - \mathcal{Y} (クロロカルボニル) \mathcal{Y} フェニルエーテル 1 . 4 8 g(5 . 0 mm o 1) と参考例 4 で得られた化合物(III)で表される 3 , 5 - \mathcal{Y} アミノー 2 ' - \mathbf{Y} チルベンズアニリド 1 . 2 0 g(5 . 0 mm o 1) をそれぞれ 1 . 0 m o 1 \mathbf{Y} 1 の濃度となるように 1 NM 1 に溶解し、1 1 1 の温度で混合し凍結させた。次に、室温までゆっくりと加温して溶液を融解させ、室温にて 1 時間攪拌した。得られた反応溶液を 1 NM 1 1 9 m 1 を加えて希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子を 1 3 1 0 m 1 を加えて希釈した度繰り返し、精製を行ったところ上記構造式 1 2 1 3 1 6 で表されるポリアミド 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 5 1 6 1 3 1 5 1 7 1 7 1 8 1 7 1 8 1 9 1 7 1 8 1 9 1 8 1 9 1

参考例 5

2-アミノトルエン1.743g(16.10mmol)をNMP6mLに溶解し、氷浴にて冷却した。ここへ4-二トロ安息香酸クロリド3.019g(16.27mmol)のNMP10mL溶液を5分かけて滴下し、更に室温に戻しながら30分間撹拌した。この溶液を水500mLに投入し、生じた沈殿を回収、充分に水洗した。乾燥後シリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:クロロホルム)で精製し、更にクロロホルム/ヘキサン混合溶媒で再結晶精製したところ、上記構造式6で表される4-二トロ-2′-メチルベンズアニリド3.604gを淡黄色針状結晶として得た(収率:87.4%)。

IR (KBr, cm^{-1}): 3304, 1649, 1603 (w), 1586 (w), 1520 (s), 1454, 1343, 1308, 1109 (w), 856 (w), 841 (w), 758, 710 (w).

¹H-NMR δ (250MHz, CDCl₃, ppm): 2.35 (3H, s), 7.18 (1H, m), 7.29 (2H, m), 7.7 (1H, bs), 7.9 (1H, bd), 8.05 (2H, d), 8.36 (2H, d).

上記の反応で得られた4-二トロー2´ーメチルベンズアニリド3.00g(11.7mmol)をエタノール20mLおよびTHF20mLの混合溶媒に溶解し、そこへ5%Pdーカーボン粉末0.25gを分散させた。-78℃で充分に減圧脱気した後、系内を水素ガスで置換し温度を室温まで上げて18時間撹拌した。セライトを用いて触媒を除去した後、溶液を濃縮したところ、上記構造

式 7 で表される 4 - アミノー 2 ′ - メチルベンズアニリド 2 . 5 1 g を淡褐色固体として得た(収率: 9 5 . 5 %)。

IR (KBr, cm⁻¹): 3476 (w), 3349, 3289 (w), 1624 (s), 1603, 1568 (w), 1526 (w), 1501 (s), 1453 (w), 1292, 1271, 1182, 843 (w), 747, 588 (w).

¹H-NMR δ (250MHz, CDCl₃, ppm): 2.33 (3H, s), 4.03 (2H, bs), 6.71 (2H, d), 7.1 (1H, m), 7.2 (2H, m), 7.6 (1H, bs), 7.72 (2H, d), 7.95 (1H, d).

上記の反応で得られた 4 - アミノー 2 ′ - メチルベンズアニリド 4 . 7 6 g (2 1 . 0 mm o 1)をNMP 2 0 mLに溶解し、氷浴にて冷却した。ここへ3,5 - ジニトロ安息香酸クロリド 4 . 8 6 g (2 1 . 1 mm o 1)のNMP 1 0 m L溶液を滴下した。室温に戻しながら3 0 分間撹拌した後、氷水 8 0 0 mLに溶液を投入した。沈殿物を遮取し水洗した後、重曹水 6 0 0 mLに分散した。再び沈殿を濾取し充分に水洗した。この沈殿をNMP 5 0 mLとエタノール 1 5 0 m Lの混合溶媒中に分散させ 8 0 ℃で加熱洗浄して濾別したところ、上記構造式 8 で表される3,5 - ジニトロー 4′ - [N-(2-メチルフェニル)カルバモイル]ベンズアニリド 7 . 3 0 gを白色粉末として得た(収率:8 2 . 3 %)。IR (KBr, cm⁻¹): 3461,3308,3090 (w),1684,1651 (s),1597,1535 (s),14 54,1400 (w),1345,1319,1273,1190 (w),916 (w),858 (w),764,731,58

¹H-NMR δ (500MHz, DMSO-d₆, ppm): 2.26 (3H, s), 7.12 (1H, m), 7.22 (1H, m), 7.28 (1H, d, J=7.3Hz), 7.36 (1H, d, J=7.3Hz), 7.95 (2H, d, J=8.7Hz), 8.05 (2H, d, J=8.7Hz), 9.04 (1H, t, J=2.1Hz), 9.21 (2H, d, J=2.0Hz), 9.84 (1H, s), 11.07 (1H, s).

元素分析結果: (分子式: C21H16N4O6、分子量: 420.38)

計算值(%); C:59.99, H:3.84, N:13.32.

8 (w).

実測値(%); C:59.85, H:3.73, N:13.27.

を水素ガスで置換し温度を室温まで上げて 6 時間撹拌した。セライトを用いて触媒を除去した後、減圧下溶液を留去して生じた沈殿を酢酸エチル 5 0 m L とエタノール 1 5 0 m L の混合溶媒中に分散させて洗浄し濾別したところ、上記構造式 (IV) で表される 3, 5 - ジアミノー4′-[N-(2-メチルフェニル) カルバモイル] ベンズアニリド <math>4. 0 3 g を白色粉末として得た(収率: 9 4. 0%)。

IR (KBr, cm⁻¹): 3410, 3324 (br), 3218, 1645 (s), 1591 (s), 1518 (s), 146 0, 1402, 1362, 1318, 1252, 1192 (w), 853, 750, 689 (w).

¹H-NMR δ (500MHz, DMSO-d₆, ppm): 2.24 (3H, s), 4.95 (4H, s), 6.02 (1H, t, J=1.9Hz), 6.32 (2H, d, J=1.9Hz), 7.15 (1H, m), 7.21 (1H, m), 7.26 (1H, d, J=7.2Hz), 7.34 (1H, d, J=7.3Hz), 7.89 (2H, d, J=8.8Hz), 7.95 (2H, d, J=8.8Hz), 9.72 (1H, s), 10.19 (1H, s).

元素分析結果: (分子式: C21H20N4O2、分子量: 360.41)

計算值(%); C:69.98, H:5.59, N:15.54.

実測値(%); C:69.47, H:5.66, N:15.36.

実施例37

アルゴンガス雰囲気下、イソフタル酸ジクロライド1.02g(5.0mmol)と参考例5で得られた化合物(IV)で表される3,5-ジアミノ-4′-[N-(2-メチルフェニル)カルバモイル] ベンズアニリド1.80g(5.

PA-37



実施例38

PA-38

アルゴンガス雰囲気下、トリメシン酸 1. 0 5 g (5.0 mm o 1) と 4, 4 $^{\prime}$ $^{\prime}$

ている)が得られる。次いで、反応溶液にアニリン 0.5 g を加え、更に 8.0 で 1.3 時間攪拌した。得られた反応溶液を過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 PA-3.8 (構造式は便宜上このように表記したが、実際には多分岐構造を有している)で表される多分岐型ポリアミド 2.1.5 g を得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PA-3.8 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ $1.9.4 \times 1.0$ 4 及び $1.9.6 \times 1.0$ 5 であった。

実施例 3 9

実施例38と同様な手法で得られた分岐状ポリアミド(*)の反応溶液にo-hリジン0.6gを加え、80Cで14時間攪拌した。得られた反応溶液を過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式PA-39(構造式は便宜上このように表記したが、実際には分岐状構造を有している)で表される多分岐型ポリアミド 2.07 gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-39 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 1.51×10^4 及び 1.02×10^5 であった。

実施例40

アルゴンガス雰囲気下、4, 4 ' - \mathcal{Y} (クロロカルボニル) ジフェニルエーテル 2 . 9 5 g (1 0 . 0 mm o 1) と 4 , 4 ' - \mathcal{Y} P \mathbb{Z} \mathcal{Y} \mathcal{Y}

参考例6

IR (KBr, cm⁻¹): 3285, 1759, 1649 (s), 1603 (w), 1586 (w), 1524, 1505, 14 56, 1370 (w), 1314, 1202 (s), 1169, 1019 (w), 914 (w), 750 (w), 685 (w). ¹H-NMR δ (250 MHz, CDCl₃, ppm): 2.36 (3H, s), 2.37 (3H, s), 7.15 (1H, m), 7.2-7.3 (4H, m), 7.63 (1H, bs), 7.93-7.96 (3H, m).

上記の反応で得られた4-アセトキシ-2'-メチルベンズアニリド3.62 5 g (13.46 m m o l) をアセトン30 m L およびメタノール10 m L の混

合溶媒に溶解し0℃に冷却した。ここへナトリウムメトキシドのメタノール溶液 (1 mol/1) 15 mL を滴下した。 $1 \text{ N塩酸 on one of measure of measu$

IR (KBr, cm⁻¹): 3264 (bs), 1620 (s), 1599 (s), 1576, 1537, 1505, 1441, 1 377 (w), 1312, 1273 (s), 1229, 1173, 1111 (w), 847 (w), 750, 588 (w).

¹H-NMR δ (250 MHz, CDCl₃, ppm): 2.35 (3H, s), 6.96 (2H, d, J=8.8Hz), 7.1 -7.3 (3H, m), 7.6 (1H, d), 7.95 (2H, d, J=8.8Hz), 8.83 (1H, bs), 8.95 (1H, s).

上記の反応で得られた 4 ーヒドロキシー 2 ′ ーメチルベンズアニリド 0.99 0 g (4.356mmol) および 2,4 ージニトロフルオロベンゼン 0.81 1 g (4.358mmol) をアセトン 20mLに溶解した。ここへ炭酸カリウム 0.6 g (4.3mmol) を加えて、還流温度で 1時間撹拌した。反応溶液を 3 過し、濾物を充分にアセトンで洗浄した。濾液を濃縮しカラムクロマトグラフィー (展開溶媒:クロロホルム)で精製したところ、上記構造式 11で表される 4 ー (2,4 ージニトロフェノキシ)ー 2 ′ ーメチルベンズアニリド 1.55 3 g を 淡黄色 固体として 得た (収率:90.63%)。

IR (KBr, cm⁻¹): 3281 (w), 3086 (s), 1649 (s), 1603, 1526 (s), 1458 (w), 1372, 1356, 1318 (w), 1281, 1198 (w), 909 (w), 866 (w), 837 (w), 743 (w), 503 (w).

¹H-NMR δ (250 MHz, Acetone-d₆, ppm): 2.37 (3H, s), 7.13-7.32 (3H, m), 7.4-7.5 (3H, m), 7.60 (1H, d, J=7.5Hz), 8.22 (2H, d, J=8.8Hz), 8.58 (1H, d d, J=2.8, 9.0Hz), 8.94 (1H, d, J=2.8Hz), 9.16 (1H, bs).

4-(2,4-ジニトロフェノキシ)-2′-メチルベンズアニリド1.55g(3.90mmol)をTHF70mLおよびエタノール30mLの混合溶媒に溶解し、ここへ5%Pd-カーボン粉末0.166gを加えた。-78℃で充分に減圧脱気した後、系内を水素ガスで置換し温度を室温まで上げて15時間撹拌した。セライトを用いて触媒を除去した後、溶液を濃縮したところ、上記構造

式 (V) で表される 4-(2, 4-i) アミノフェノキシ) -2'-i メチルベンズアニリド1. 26g を淡褐色固体として得た(収率: 96.7%)。

IR (KBr, cm⁻¹): 3349 (br), 2955 (w), 1626 (s), 1605 (s), 1499 (s), 1456, 1314 (w), 1231 (s), 1167, 851, 754, 596 (w).

¹H-NMR δ (250 MHz, CDCl₃, ppm): 2.14 (3H, s), 4.52 (2H, bs), 4.68 (2H, bs), 5.78 (1H, dd, J=2.5, 8.4Hz), 5.99 (1H, d, J=2.5Hz), 6.50 (1H, d, J=8.4Hz), 6.84 (2H, d, J=8.8Hz), 7.05-7.26 (4H, m), 7.86 (2H, d, J=8.8Hz), 9.64 (1H, s).

EI-MS (m/z): 333 (M^+) , 227 $(M - toluylamino)^+$, 199 $(M - CONHC_7H_7)^+$, 123 $(2, 4-Diaminophenoxyl)^+$, 106 $(toluylamilino)^+$.

元素分析結果: (分子式: C20H19N3O2、分子量: 333.39)

計算值(%); C:72.05, H:5.74, N:12.60.

実測値(%); C:71.78, H:6.14, N:11.62.

実施例41

た。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ上記構造式 PA-41 で表されるポリアミド 2.8 4 gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PA-41 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 1.0 2 × 10 4 及び 1.9 2 × 10 4 であった。

実施例42

アルゴンガス雰囲気下、水素化ナトリウム(油性、60%)36.3 mg(0.91 mmol)をDMSO12 ml中に分散させ、70℃で1時間撹拌し淡黄色の均一溶液を得た。室温に冷却した後、この溶液に実施例1で得られたポリアミド PA-1、0.60 gを加えて溶解させ更に室温にて4時間撹拌した。次に、ヨードエタン0.52 g(3.33 mmol)を加え室温にて更に2時間撹拌し、この溶液を過剰のメタノールにあけ析出した高分子を濾過し乾燥したところ、ポリマー0.57 gを得た。得られたポリマーの 1 H 1 N M R 1 スペクトルを測定したところ、PA-1で表される構造中のアミド基のN位のうち27モル%がエチル基に置換されたポリアミド(以下、PA-42と称する)であった。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-42の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ1.36×10 4 及び2.66×10 4 であった。

実施例43

アルゴンガス雰囲気下、水素化ナトリウム(油性、60%) 48.4mg(1.21mmol)をDMSO10ml中に分散させ、70%で1時間撹拌し淡黄色の均一溶液を得た。室温に冷却した後、この溶液に実施例1で得られたポリアミドPA-1、0.50gを加えて溶解させ更に室温にて4時間撹拌した。次に、2-3-ドプロパン0.57g(3.35mmol)を加え50%にて更に4時間撹拌し、この溶液を過剰のメタノールにあけ析出した高分子を濾過し乾燥したところ、ポリマー0.53gを得た。得られたポリマーの 1 H-NMRスペクトルを測定したところ、PA-1で表される構造中のアミド基のN位のうち7.8モル%がイソプロピル基に置換されたポリアミド(以下、PA-43と称する)であった。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-43の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 1.45×10^4 及び 3.04×10^4 であった。

実施例44

アルゴンガス雰囲気下、水素化ナトリウム(油性、60%) 3 6 . 3 mg(0 . 9 1 mm o 1)を DMS O 1 2 m l 中に分散させ、7 0 $\mathbb C$ で 1 時間撹拌し淡黄色の均一溶液を得た。室温に冷却した後、この溶液に実施例 1 で得られたポリアミド P A - 1、0 . 6 0 g を加えて溶解させ更に室温にて 4 時間撹拌した。次に、アリルブロミド 0 . 4 4 g(3 . 6 3 mm o 1)を加え室温にて更に 2 時間撹拌し、この溶液を過剰のメタノールにあけ析出した高分子を濾過し乾燥したところ、ポリマー 0 . 5 8 g を得た。得られたポリマーの 1 H - N M R スペクトルを測定したところ、P A - 1 で表される構造中のアミド基のN位のうち 2 3 モル%がアリル基に置換されたポリアミド(以下、P A - 4 4 と称する)であった。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた P A - 4 4 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 1 . 6 6 \times 1 0 4 及び 3 . 4 0 \times 1 0 4 であった。

実施例45

アルゴンガス雰囲気下、水素化ナトリウム(油性、60%) 36.3 mg(0.91 mmol)をDMSO12ml中に分散させ、70%で1時間撹拌し淡黄色の均一溶液を得た。室温に冷却した後、この溶液に実施例1で得られたポリアミドPA-1、0.60 gを加えて溶解させ更に室温にて4時間撹拌した。次に、ベンジルブロミド0.62 g(3.63 mmol)を加え室温にて更に2時間撹拌し、この溶液を過剰のメタノールにあけ析出した高分子を濾過し乾燥したところ、ポリマー0.64 gを得た。得られたポリマーの 1 H-NMRスペクトルを測定したところ、PA-1で表される構造中のアミド基のN位のうち23モル%がベンジル基に置換されたポリアミド(以下、PA-45と称する)であった。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-45の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ1. 60×10^4 及び3. 26×10^4 であった。



実施例46

アルゴンガス雰囲気下、 4 、 4 、 - ジ (クロロカルボニル) ジフェニルエーテル 1 . 4 8 g(5 . 0 mm o 1) と 3 、 3 、 5 、 5 、 - テトラメチル - 4 、 4 、 - ジアミノジフェニルメタン 1 . 5 7 g(5 . 0 mm o 1) をそれぞれ 1 . 0 mo 1 / 1 の濃度となるように 1 NM 1 に溶解 1 、 - 7 8 1 の温度で混合し凍結させた。次に、室温までゆっくりと加温して溶液を融解させ、室温にて 1 時間 提押した。得られた反応溶液を 1 NM 1 3 8 m 1 で希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 1 2 A 1 6 で表されるポリアミド 1 2 . 1 6 8 gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた 1 3 × 1 0 1 及び 1 2 . 1 4 1 0 1 であった。

実施例47

アルゴンガス雰囲気下、水素化ナトリウム(油性、60%)36.3mg(0.91mmol)をDMSO12ml中に分散させ、70℃で1時間撹拌し淡黄色の均一溶液を得た。室温に冷却した後、この溶液に実施例1で得られたポリアミドPA-1、0.60gを加えて溶解させ更に室温にて4時間撹拌した。次に、1-ヨードへキサデカン1.28g(3.63mmol)を加え室温にて更に4時間撹拌し、この溶液を過剰のメタノール/ヘキサン混合溶媒にあけ析出した高分子を濾過し乾燥したところ、ポリマー0.59gを得た。得られたポリマーの「H-NMRスペクトルを測定したところ、PA-1で表される構造中のアミド基のN位のうち19モル%がヘキサデシル基に置換されたポリアミド(以下、PA-47と称する)であった。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求め

た P A - 4 7 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 1. 5 9 × 1 0 ⁴及び 3. 3 6 × 1 0 ⁴であった。

実施例48

アルゴンガス雰囲気下、 4 、 4 、 4 、 - ジカルボキシジフェニルエーテル 1 . 3 7 g(5. 3 1 mm o 1)、 1 - オクタドデシルオキシー 2 、 4 - ジアミノベンゼン 0 . 4 0(1. 0 6 mm o 1)及び 4 - メチルーmーフェニレンジアミン 0 . 5 2 g(4. 2 5 mm o 1)を NMP 6 . 0 0 m 1 に溶解し、この溶液に Py 1 . 3 0 m 1 及び 1 P P 1 . 1 2 0 m 1 を加え、 1 0 0 1 に加熱した後 1 7 時間攪拌した。 得られた反応溶液を NMP 1 0 m 1 で 1 の 1 で 1 で 1 の 1 で 1 の 1 で 1 で 1 で 1 の 1 で 1 で 1 で 1 の 1 で 1 で 1 の 1 で 1 で 1 で 1 で 1 の 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 の 1 で 1 の 1 で

実施例49

アルゴンガス雰囲気下、4,4′-ジカルボキシジフェニルエーテル1.36

g(5.26 mmol)、4-(4-h)ランス-n-nプチルシクロn+2ルフェノキシ)-1, 3-3アミノベンゼン0. 40(1.05 mmol)及び4-2 メチル-m-7エニレンジアミン0.51g(4.20 mmol)をNMP6.0 mlに溶解し、この溶液にPy1.30 ml及びTPP4.20 mlを加え、100 に加熱した後17時間攪拌した。得られた反応溶液をNMP10 mlで希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式PA-49で表されるポリアミド2.05gを得た。PA-49の 1 H-NMRスペクトルを測定したところ、x/y共重合比は79.9/20.1であった。また、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPA-49の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ7.19×10 3 及び1.47×10 4 であった。

実施例50

重量平均分子量はそれぞれ8.49×10³及び1.58×10⁴であった。 実施例51

窒素気流中、1, 3-ジ [4-PミノベンズPミド] ベンゼン1. 04g(3. 0mmol) と1, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボン酸二無水物0. 59g(3. 0mmol) をNMP9. 13m1中で、室温で3時間反応させて上記構造式で表されるポリアミド酸PAA-1を調製した。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPAA-1の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ3. 35×103及び5. 21×103であった。

実施例 5 2

窒素気流中、1,4-ジ[(4-アミノフェニル)カルバモイル]ベンゼン3.46g(10mmol)と1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物(以下CBDAと略す)1.92g(9.8mmol)をNMP30.62ml中で、室温で6時間反応させて上記構造式で表されるポリアミド酸PAA-

2 を調製した。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PAA-2の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 7. 12×10^3 及び 1.65×10^4 であった。

実施例53

窒素気流中、1, 3-ジ [4-アミノベンズアミド] ベンゼン1. 04g (3 mm o 1) と C B D A 0. 58g (2. 94mm o 1) を N M P 9. 16m l 中で、室温で 6 時間反応させて上記構造式で表されるポリアミド酸 P A A -3 を調製した。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた P A A -3 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 3. 13×10^4 及び 5. 45×10^4 であった。

実施例54

窒素気流中、参考例3で得られた化合物 (II) で表される4, 4′-ジ(4-アミノベンズアミド) ジフェニルエーテル1. 01g(2.3mmol) とCBDA0.44g(2.25mmol)をNMP8.00ml中で、室温で6時間

反応させて上記構造式で表されるポリアミド酸 PAA-4 を調製した。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PAA-4 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 1.50×10^4 及び 3.04×10^4 であった。

実施例55

窒素気流中、参考例2で得られた化合物(I)で表される4, 4 ' - ジ [N- (2-メチル-5-アミノフェニル)カルボニルアミノ] ジフェニルエーテル0. 98g (2.1 mmol) とCBDA0.40g (2.06mmol) をNMP 7.84m1中、室温で6時間反応させて上記構造式で表されるポリアミド酸PAA-5を調製した。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPAA-5の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 6.64×10^4 及び 1.08×10^5 であった。

参考例7

アルゴンガス雰囲気下、水素化ナトリウム(油性、60%) 1. 64g(40 mmol)をDMSO100mL中に分散させ、70℃で1時間撹拌し淡黄色の均一溶液を得た。室温に冷却した後、この溶液に参考例3で得られたジニトロ化合物4、7.00g(14.0mmol)を加え室温にて4時間撹拌した。次に、ヨードメタン6.08g(40mmol)を加え室温にて更に18時間撹拌し、この溶液を200mLの水にあけ、析出した沈殿を濾過し乾燥した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:クロロホルム/酢酸エチル)で精製したところ、上記構造式12で表される4,4′ージ(Nーメチルー4ーニトロベンズアミド)ジフェニルエーテル3.56gを淡黄色粉末として得た(収率:48.3%)。

¹H-NMR δ (250MHz, CDCl₃, ppm): 3.52 (6H, s), 6.82 (4H, d), 7.00 (4H, d), 7.48 (4H, d), 8.08 (4H, d).

上記の反応で得られた 4 , 4 ' - ジ (N - メチル - 4 - - N - N - N +

IR (KBr, cm⁻¹): 3452, 3333, 3120, 2937, 1363, 1620, 1600.

'H-NMR δ (250MHz, DMS0-d₆, ppm): 3.26 (6H, s), 5.40 (4H, bs), 6.30 (4H, d), 6.80 (4H, d), 6.94 (4H, d), 7.10 (4H, d).

元素分析結果: (分子式: C28H26N4O3、分子量: 466.53)

計算值(%); C:72.08, H:5.62, N:12.00.

実測値(%); C:71.60, H:5.65, N:11.76.

実施例56

窒素気流中、参考例 7 で得られた化合物(VI)で表される化合物 4 、 4 $^{\prime}$ ージ (N - メチルー 4 - アミノベンズアミド)ジフェニルエーテル 0 . 6 6g(1 . 5 mm o 1)と C B D A 0 . 2 9g(1 . 4 7 mm o 1)を N M P 5 . 3 8 m 1 中で、室温で 6 時間反応させて上記構造式で表されるポリアミド酸 P A A - 6 を 調製した。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた P A A - 6 の数 平 均分子量及び重量 平均分子量はそれぞれ 2 . 3 1 × 1 0 $^{\prime}$ 及び 3 . 6 0 × 1 0 $^{\prime}$ で あった。

実施例 5 7

窒素気流中、1,3-ジ [4-アミノベンズアミド] ベンゼン1.04g(3.0mmol)と3,3['],4,4[']-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物0.96g(2.97mmol)をNMP11.31ml中で、室温で3時間反応させて上記構造式で表されるポリアミド酸PAA-7を調製した。ゲルパーミ

エーションクロマトグラフィーで求めた PAA-7 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 1.60×10^4 及び 3.08×10^4 であった。 実施例 58

実施例59

窒素気流中、1,3-ジ[4-アミノベンズアミド]ベンゼン1.04g(3.0mmol)と1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)プロパン二無水物1.33g(3.0mmol)をNMP13.44ml中で、室温で3時間反応させて上記構造式で表されるポリアミド酸PAA-9を調製した。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求

めた PAA-9 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 2.37×10^4 及び 4.22×10^4 であった。

実施例60

窒素気流中、1, 3-ジ [4-PミノベンズPミド] ベンゼン1. 04g(3. 0 mm o 1) とビス(3, 4-ジカルボキシフェニル) スルホン二無水物1. 07g(3. 0 mm o 1) をNMP11. 98m1中で、室温で3時間反応させて上記構造式で表されるポリアミド酸PAA-10を調製した。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPAA-10の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ1. 81×104及び3. 40×104であった。

実施例61

アルゴンガス雰囲気下、4, 4 ' - ジ P = 2 = 3 1 = 2 = 3 2 = 2 = 4



のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 PAA-11 で表されるポリイミド3.88gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PAA-11の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ6.81×10³及び1.15×10⁴であった。

実施例62

アルゴンガス雰囲気下、4, 4 ' - ジアミノジフェニルメタン1. 98g(10mmol) とトリメリット酸一無水物酸クロライド 2. 10g(10mmol) をNMP溶液 2 2. 53ml 中で、室温で 6 時間反応させて、記構造式で表されるポリアミド酸 PAA - 1 2 を調製した。次いで、この反応溶液にNMP 7 3ml を加えて希釈し、これに無水酢酸 9. 50ml 及び Py 4. 90ml を加え、40 ∞ に加熱した後 3 時間攪拌した。得られた反応溶液をメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 PI - 1 2 で表されるポリイミド 3. 2 6 g を得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PI - 1 2 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 5. 8 9×10 3 及び 1. 0 6×10 4 であった。

実施例63

アルゴンガス雰囲気下、ビスフェノールAビス(クロロフォルメート) 1.7 7g(5.0 mm o 1)と 4 - メチルーm - フェニレンジアミン 0.6 1g(5.0 mm o 1)を NM P 1 3.1 4 m 1 に溶解し、これを室温で 1 4 時間攪拌した。得られた反応溶液を NM P 1 8 m 1 で希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子を 3 過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 P U - 1 で表されるポリウレタン 1.1 4 gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた P U - 1 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 4.26×10³及び 5.64×10³であった。

実施例64

アルゴンガス雰囲気下、ビスフェノールAビス(クロロフォルメート) 1.7 7g(5.0 mm o l) と 4,4 $^{\prime}$ $^{\prime$

gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPU-2の数平均 分子量及び重量平均分子量はそれぞれ5.63×103及び8.70×103であ った。

実施例65

PU-3

アルゴンガス雰囲気下、4-メチル-1,3-フェニレンジイソシアネート1. 74g(10.0mmol)と4,4′-ジアミノジフェニルエーテル2.00 g (10.0mmol)をDMSO23.60mlに溶解し、60℃に加熱後1 5 分攪拌した。得られた反応溶液をDMSO26mlで希釈した後、過剰のメタ ノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精 製を行ったところ、上記構造式PU-3で表されるポリウレア2.77gを得た。 ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPU-3の数平均分子量及び 重量平均分子量はそれぞれ1.83×10⁴及び5.40×10⁴であった。

実施例66

アルゴンガス雰囲気下、水素化ナトリウム(油性、60%)85.5mg(2. 14mmol)をDMSO20ml中に分散させ、70℃で1時間攪拌し淡黄色 の均一溶液を得た。室温に冷却した後、この溶液に実施例65で得られたポリウ レアPU-3、1.0g(2.67mmol)を加えて溶解させ、更に室温にて 4 時間攪拌した。次に、ヨードメタン0. 9 1 g (6. 4 1 m m o 1) を加え室 温にて、更に2時間攪拌し、この溶液を過剰のメタノールにあけ析出した高分子 をろ過し乾燥したところ、ポリマー0.93gを得た。得られたポリマーの'H - NMRスペクトルを測定したところ、PU-3で表される構造中のウレア基の N位のうち19モル%がメチル基に置換されたポリウレア(以下、PU-4と称 する)であった。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPU-4の

数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 9.79×10°及び 2.04×10°であった。

実施例67

アルゴンガス雰囲気下、4-メチル-1, 3-フェニレンジイソシアネート3. 0.5 g(1.7. 5 mm o 1)と1, 3-ジアミノシクロヘキサン2. 0.0 g(1.7. 5 mm o 1)をDMSO1.7 m 1 に溶解し、6.0 1 に加熱後1.5 分攪拌した。得られた反応溶液をDMSO1.7 m 1 で希釈して、上記構造式 PU-5 で表されるポリウレア1.5 の1.5 gを含むDMSO溶液約1.5 m 1.5 を得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PU-5 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ1.5 3、1.5 2 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 4 であった。

実施例68

アルゴンガス雰囲気下、4-メチル-1, 3-フェニレンジイソシアネート 1. 74g (10.0mmol) とイソフタル酸ジアジド 1.64g (10.0mmol) とイソフタル酸ジアジド 1.64g (10.0mmol) をDMSO 15m·l に溶解し、この溶液に触媒としてトリエチルアミン 8.36m·l を加え、120 に加熱した後 14 時間攪拌した。得られた反応溶液をDMSO 24m·l で希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ

過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 PU -6 で表されるポリマー 2. 6 7 gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PU -6 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 2. 4 1 \times 1 0 3 及び 3. 4 0×1 0 3 であった。

実施例69

アルゴンガス雰囲気下、4-メチル-1, 3-フェニレンジイソシアネート1. 74g(10.0mmol) とテレフタル酸ジアジド1.64g(10.0mmol) をDMSO15ml に溶解し、この溶液に触媒としてトリエチルアミン8. 36ml を加え、120 Cに加熱した後14 時間攪拌した。得られた反応溶液をDMSO24ml で希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 PU-7 で表されるポリマー2.54g を得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた PU-7 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ2.39 × 10^3 及び 3.11×10^3 であった。

実施例70

アルゴンガス雰囲気下、4-メチル-1,3-フェニレンジイソシアネート1.

74g(10.0mmol)とイソフタル酸ジヒドラジド1.94g(10.0mmol)をDMSO22.30mlに溶解し、120℃に加熱した後30分攪拌した。得られた反応溶液をDMSO26mlで希釈した後、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式PU-8で表されるポリマー3.50gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPU-8の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ4.54×10 3 及び7.96×10 3 であった。実施例71

実施例72

アルゴンガス雰囲気下、イソフタル酸ジクロライド 0. 5 2 3 g(2. 5 7 m m o 1)とテレフタル酸ジヒドラジド 0. 5 0 0 g(2. 5 7 m m o 1)を N M P 5. 0 m 1 に溶解し、これを-78 \mathbb{C} \sim 室温にかけて 4 時間攪拌した。次いで、過剰のメタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行ったところ、上記構造式 P U -1 0 で表されるポリマー 0. 5 8 gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた P U -1 0 の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 5. 0 7 × 1 0 3 及び 8. 1 5 × 1 0 3 であった。

実施例73

アルゴンガス雰囲気下、水素化ナトリウム(油性、60%) 168mg(7. 01mmo1)をDMSO20ml中に分散させ、70%で1時間攪拌し淡黄色の均一溶液を得た。室温に冷却した後、この溶液に実施例67%で得られたポリウレアPU-5のDMSO溶液17mlを加えて、更に室温にて4時間攪拌した。その後ヨードメタン2. 98g(21. 0mmo1)を加え室温にて、更に2時間攪拌し、この溶液を過剰のメタノールにあけ析出した高分子をろ過し乾燥したところ、ポリマー1. 93gを得た。得られたポリマーの ^1H-NMR スペクトルを測定したところ、PU-5で表される構造中のウレア基のN位のうち16モル%がメチル基に置換されたポリウレア(以下、PU-11と称する)であった。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めたPU-11の数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ1. 33×10^4 及び2. 82×10^4 であった。実施例 $74\sim123$

実施例1から実施例50で得られたポリアミドPA-1~PA-50を所定の

混合比(重量比)のNMPとブチルセロソルブ(以下BCと略す)の混合溶媒に 溶解させ、それぞれ所定の固形分濃度になるように溶液を調製した。この溶液を ガラス基板上に所定の回転数でスピンコートし、80℃で5分乾燥させた後、1 80℃で1時間加熱処理を行ったところ、いずれのポリアミド溶液でも膜厚10 00Åの均一なポリアミド樹脂膜を得ることができた。このようにして得た各ポ リアミド樹脂膜にバンドパスフィルター及び偏光板を介して、出力700Wの超 高圧水銀灯から波長 2 4 0 n m ~ 2 8 0 n m または 3 0 0 n m ~ 3 3 0 n m の偏 光紫外線を所定の時間照射した。偏光紫外線を同一の条件で照射した2枚1組の 基板をポリアミド面が内側を向き、照射した偏光紫外線の方向が互いに平行にな るように、6μmのポリマー微粒子を挟んで張り合わせ、液晶セルを作製した。 これらのセルをホットプレート上で液晶のアンソトロピック温度以上に保ち、液 晶(メルク社製スLI-2293)を注入した。これらの液晶セルを室温まで冷 却後偏光顕微鏡のクロスニコル下で回転させたところ、いずれのポリアミド樹脂 膜を用いた場合でも明瞭な明暗を生じ、且つ欠陥も全く観測されず、液晶が均一 に配向していることが確認された。表3にPA-1~PA-50の各ポリアミド 溶液のNMPとBCの混合比、総固形分及びスピンコート回転数を示し、表4に は各ポリアミド樹脂膜を用いた液晶セル作製時の偏光紫外線の照射時間を示す。

更に上記ポリアミドPA-1~PA-50の各条件で作製した液晶セルを120℃のオーブン中で1時間熱処理を行った後、室温まで冷却した。これらの液晶セルを偏光顕微鏡のクロスニコル下で回転させたところ、いずれのセルに於いても、明瞭な明暗を生じ、且つ欠陥は観測されず、加熱処理前の均一な液晶の配向が保たれていることが確認された。

表3 ポリアミド溶液のNMP, BC混合比、総固形分及びスピンコート回転数

実施例	ポリアミド	NMPとBC	総固形分	スピンコート
	の番号	の重量比	(%)	回転数(rpm)
7 4	P A - 1	80:20	5. 0	4000
7 5	PA-2	90:10	5.0	3 2 0 0
7 6	P A - 3	90:10	5. 0	3000
7 7	PA-4	80:20	6. 0	3 1 0 0
7 8	PA - 5	90:10	6. 0	2500
7 9	PA-6	90:10	6.0	2700
8 0	PA-7	80:20	5. 0	2000
8 1	PA-8	80:20	5. 0	2000
8 2	PA-9	80:20	5. 0	2000
8 3	PA-10	80:20	5. 0	2000

表3 続き

女 り が こ				
実施例	ポリアミド	NMPとBC	総固形分	スピンコート
!	の番号	の重量比	(%)	回転数(rpm)
8 4	PA-11	80:20	6. 0	3 3 0 0
8 5	PA-12	80:20	7. 0	2500
8 6	PA-13	80:20	7.0	2300
8 7	PA-14	80:20	6.0	2700
8 8	PA-15	80:20	6.0	2700
8 9	PA-16	80:20	7.0	3000
9 0	PA-17	80:20	5.0	2000
9 1	PA-18	90:10	6. 0	2600
9 2	PA-19	80:20	5. 0	2000
9 3	PA-20	80:20	6.0	2600
9 4	PA-21	80:20	6.0	3 2 0 0
9 5	PA-22	80:20	5. 0	2900
9 6	PA-23	80:20	5. 0	3 3 0 0
9 7	PA-24	80:20	5. 0	3 4 0 0
98	PA-25	80:20	5. 0	3000
9 9	PA-26	80:20	5.0	4 3 0 0
100	PA-27	80:20	5. 0	2600
1 0 1	PA-28	80:20	5. 0	3 2 0 0
102	PA-29	80:20	5. 0	3900
103	PA-30	80:20	5. 0	2800
104	PA-31	80:20	5.0	2700
1 0 5	PA-32	90:10	6.0	3 0 0 0
106	PA-33	80:20	6.0	3000
107	PA-34	80:20	5. 0	3 3 0 0
1 0 8	PA-35	90:10	5. 0	2 3 0 0

表3 続き

実施例	ポリアミド	NMPとBC	総固形分	スピンコート
	の番号	の重量比	(%)	回転数(rpm)
1 0 9	PA-36	80:20	5. 0	3 5 0 0
1 1 0	PA-38	80:20	6.0	2000
1 1 1	PA-38	80:20	5. 0	3000
1 1 2	PA-39	80:20	5. 0	2600
1 1 3	PA-40	80:20	6.0	3700
114	PA-41	80:20	6.0	2000
1 1 5	PA-42	80:20	5. 0	3 2 0 0
116	PA-43	80:20	5. 0	3 3 0 0
1 1 7	PA-44	80:20	5.0	3500
118	PA-45	80:20	5. 0	3 5 0 0
119	PA-46	80:20	5. 0	3000
1 2 0	PA-47	80:20	5. 0	3 2 0 0
121	PA-48	70:30	6. 0	2800
1 2 2	PA-49	70:30	6.0	3 3 0 0
1 2 3	PA-50	70:30	6. 0	2700

表 4 各ポリアミド樹脂膜を用いた液晶セル作製時の偏光紫外線照射時間

実施例	ポリアミド	偏光紫外線照	射時間(sec)
	の番号	波長 240~280nm	波長 300~330nm
7 4	P A - 1	7 2 0	2 7
7 5	P A - 2	7 2 0	2 7
7 6	P A - 3	7 2 0	2 7
7 7	P A - 4	7 2 0	2 7
7 8	PA-5	3600	9 0
7 9	PA-6	7 2 0	2 7

表 4 続き

実施例	ポリアミド	偏光紫外線照射時間(sec)		
	の番号	波長 240~280nm	波長 300~330nm	
8 0	P A - 7	3600	9 0	
8 1	P A - 8		4 5 0	
8 2	PA-9	7 2 0	4 5 0	
8 3	PA-10	5 4 0	4 5	
8 4	PA-11	3 6 0	4 5	
8 5	PA-12		9 0	
8 6	PA-13		4 5 0	
8 7	PA-14		4 5	
8 8	PA-15	720	4 5	
8 9	PA-16	720	4 5 0	
9 0	PA-17	7 2 0	9 0	
9 1	PA-18	3600	4 5	
9 2	PA-19	180	4 5 0	
9 3	PA-20	7 2 0	9 0	
9 4	PA-21	720	4 5 0	
9 5	PA-22	180	4 5	
9 6	PA-23	180	1 4	
9 7	PA-24	360	4 5	
9 8	PA-25	360	9 0	
9 9	PA-26	720	2 3	
1 0 0	PA-27	5 4		
101	PA-28	7 2		
1 0 2	PA-29	5 4		
1 0 3	PA-30	5 4		
1 0 4	PA-31	7 2 0	1 8	

表4 続き

実施例	ポリアミド	偏光紫外線照射時間(sec)	
	の番号	波長 240~280nm	波長 300~330nm
1 0 5	PA-32	7 2 0	2 3
106	PA-33	7 2 0	1 8
107	PA-34	1 4 4 0	180
108	PA-35	1080	180
109	PA-36	7 2 0	9 0
1 1 0	PA-37	1 4 4 0	9 0
1 1 1	PA-38	7 2 0	180
1 1 2	PA-39	7 2 0	1 3 5
1 1 3	PA-40	180	2 3
114	PA-41	1 4 4 0	9 0
1 1 5	PA-42	1080	4 5
1 1 6	PA-43	7 2 0	4 5
1 1 7	PA-44	1080	4 5
1 1 8	PA-45	1080	4 5
1 1 9	PA-46	144	
1 2 0	PA-47	3600	
1 2 1	PA-48		9 0
1 2 2	PA-49		450
1 2 3	PA-50	7 2 0	4 5 0

実施例124~135

実施例 5 1 から実施例 6 1 で得られたポリアミド酸 $PAA-1\sim PAA-1$ 1 を NMP と B C の混合溶媒(重量比 8 0 : 2 0)に溶解させ、それぞれ所定の固形分濃度になるように溶液を調製した。この溶液をガラス基板上に所定の回転数でスピンコートし、 8 0 \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{C} 5 分乾燥させた後、 2 \mathbb{C} \mathbb{C}

更に上記ポリイミドPI-1~PI-12の各条件で作製した液晶セルを120℃のオーブン中で1時間熱処理を行った後、室温まで冷却した。これらの液晶セルを偏光顕微鏡のクロスニコル下で回転させたところ、いずれのセルに於いても、明瞭な明暗を生じ、且つ欠陥は観測されず、加熱処理前の均一な液晶の配向が保たれていることが確認された。

表 5 ポリアミド酸及びポリイミド溶液の総固形分及びスピンコート回転数

実施例	ポリアミド酸	総固形分	スピンコート
	及びポリイミ	(%)	回転数(rpm)
	ドの番号	-	
1 2 4	P A A - 1	7.0	4500
1 2 5	P A A - 2	6.0	2400
1 2 6	P A A - 3	5.0	4500
1 2 7	P A A - 4	5.0	3 1 0 0
1 2 8	P A A - 5	5.0	4700
129	P A A - 6	7.0	3000
1 3 0	P A A - 7	5.0	4000
131	P A A - 8	5.0	3 2 0 0
1 3 2	P A A - 9	5.0	4500
1 3 3	P A A - 1 0	6.0	3800
1 3 4	PAA-11	5.0	2300
1 3 5	PI-12	6. 0	2700

表 6 各ポリイミド樹脂膜を用いた液晶セル作製時の偏光紫外線照射時間

実施例	ポリイミド	偏光紫外線照射時間(sec)	
	の番号	波長 240~280nm	波長 300~330nm
1 2 4	P I - 1	7 2 0	1 8 0
1 2 5	P I - 2	2 1 6 0	270
1 2 6	P I - 3	3 6 0	4 5
1 2 7	P I - 4	3 6 0	9 0
1 2 8	P I - 5	180	9 0
1 2 9	P I - 6	3 6 0	450
1 3 0	PI-7	1 4 4 0	270
1 3 1	P I - 8	7 2 0	180
1 3 2	P I - 9	7 2 0	9 0
1 3 3	P I - 1 0	1440	180
1 3 4	P I - 1 1	7 2 0	450
1 3 5	P I - 1 2	3 6 0	4 5 0

実施例136~146

実施例63から実施例73で得られたポリウレタンやポリウレア等のアミド類似基を含有するポリマーPU-1~PU-11をNMPとBCの混合溶媒(重量比80:20)に溶解させ、それぞれ所定の固形分濃度になるように溶液を調製した。この溶液をガラス基板上に所定の回転数でスピンコートし、80℃で5分乾燥させた後、180℃で1時間加熱処理を行うことにより膜厚1000Aの均一なポリマー樹脂膜を得ることができた。このようにして得た各ポリマー樹脂膜に対し実施例74~135と全く同様にして波長240nm~280nmの偏光紫外線を所定の時間照射し、液晶セルを作製した。これらの液晶セルをクロスニコル下で回転させたところ、いずれのポリマー樹脂膜を用いた場合でも明瞭な明暗を生じ、且つ欠陥も全く観測されず、液晶が均一に配向していることが確認された。表7にPU-1~PU-11の総固形分及びスピンコート回転数を示し、表8には各ポリマーを用いた液晶セル作製時の偏光紫外線の照射時間を示す。

更に上記ポリマーPU-1~PU-11の各条件で作製した液晶セルを120 ℃のオーブン中で1時間熱処理を行った後、室温まで冷却した。これらの液晶セルを偏光顕微鏡のクロスニコル下で回転させたところ、いずれのセルに於いても、明瞭な明暗を生じ、且つ欠陥は観測されず、加熱処理前の均一な液晶の配向が保たれていることが確認された。

表 7 アミド類似基含ポリマー溶液の総固形分及びスピンコート回転数

実施例	アミド類似基	総固形分	スピンコート
	含有ポリマー	(%)	回転数(rpm)
	の番号		
1 3 6	PU-1	6.0	2700
1 3 7	PU-2	6.0	2200
138	P U - 3	5. 0	3 2 0 0
139	PU-4	6.0	2800
140	PU-5	7. 0	3 3 0 0
141	P U - 6	7.0	2000
1 4 2	PU-7	7. 0	2000
1 4 3	PU-8	6.0	2 3 0 0
1 4 4	PU-9	6.0	2000
1 4 5	PU-10	6.0	2000
146	PU-11	7.0	2800

表8 アミド類似基含有ポリマー樹脂膜を用いた液晶セル作製製時の 偏光紫外線照射時間

実施例	アミド類似基	偏光紫外線照射時間(sec)
	含有ポリマー	波長 240~280nm
	の番号	
1 3 6	PU-1	1 8 0
1 3 7	PU-2	3600
1 3 8	P U - 3	7 2
1 3 9	PU-4	1 4 4
1 4 0	PU - 5	3 6 0
1 4 1	PU-6	7 2 0
1 4 2	PU-7	3 6 0
1 4 3	PU-8	3600
1 4 4	PU-9	1 8 0
1 4 5	PU-10	1 4 4 0
146	PU-11	1 4 4 0

比較例 1

6・6ナイロン(分子量約20000、ガラス転移温度約45℃)をm-クレゾール中に溶解させ、総固形分4%の溶液を調製した。この溶液をガラス基板上に5000rpmでスピンコートし、ついで120℃で5分乾燥した後、180℃で1時間熱処理を行うことにより、厚さ1000Åのポリアミド樹脂膜を作製した。この6・6ナイロンの膜に実施例と同様に、偏光紫外線波長240nm~280nmを1時間または300nm~330nmを15分間照射した後、液晶セルを作製した。これらのセルを偏光顕微鏡のクロスニコル下で回転させたところ、明暗を生じず、液晶は全く配向しなかった。

比較例2

窒素気流下、アジピン酸クロライド1. 83g(10.0mmol)とm-フ

エニレンジアミン1. 08g(10.0mmol)をNMP20.29mlに溶解し、この溶液にPy1.94mlを加え、これを-78 \mathbb{C} \sim 室温にかけて3時間攪拌した。得られた反応溶液をNMP15mlで希釈した後、メタノールにあけ、析出した高分子をろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行い、ポリアミド2.18gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ1.09×10 4 及び2.62×10 4 であった。

このポリアミドをNMP及びBCの混合溶媒(重要比9:1)により総固形分5%の溶液に調製した。この溶液をガラス基板上に3000rpmでスピンコートし、ついで80℃で5分乾燥した後、180℃で1時間熱処理を行うことにより、厚さ1000Åのポリアミド樹脂膜を作製した。実施例と同様に、ポリアミド樹脂膜に偏光紫外線波長240nm~280nmを1時間または300nm~330nmを15分間照射した後、液晶セルを作製した。これらのセルを偏光顕微鏡のクロスニコル下で回転させたところ、明暗を生じず、液晶は全く配向しなかった。

比較例3

窒素気流下、イソフタル酸クロライド 2.0 3 g(1 0.0 mmol)と 1, 4 - ジアミノブタン 0.8 8 g(1 0.0 mmol)を NMP 2 0.2 9 mlに溶解し、この溶液に Py 1.9 4 mlを加え、これを - 7 8 \mathbb{C} ~室温にかけて 3 時間攪拌した。得られた反応溶液を NMP 1 5 mlで希釈した後、メタノールにあけ、析出した高分子を ろ過し乾燥した。上記操作を再度繰り返し、精製を行い、ポリアミド 2.0 7 gを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた数平均分子量及び重量平均分子量はそれぞれ 6.5 3 × 1 0 3 及び 1.3 0 × 1 0 3 であった。

このポリアミドをm-クレゾールにより総固形分4%の溶液に調製した。この溶液をガラス基板上に5000rpmでスピンコートし、ついで120℃で5分乾燥した後、180℃で1時間熱処理を行うことにより、厚さ1000Åのポリアミド樹脂膜を作製した。実施例と同様に、ポリアミド樹脂膜に偏光紫外線波長240nm~280nmを15分間照射

した後、液晶セルを作製した。これらのセルを偏光顕微鏡のクロスニコル下で回転させたところ、明暗を生じず、液晶は全く配向しなかった。

比較例4

窒素気流下、ピロメリット酸二無水物 2. 1 4 g (9.8 mm o 1) と 4, 4 / ージアミノジフェニルエーテル 2.00 g (10.0 mm o 1) を N M P 27.6 0 m 1 中、室温で 2 時間反応させポリイミド前駆体溶液を調製した。重合反応は容易且つ均一に進行した。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた数平均分子量及び重量平均分子量がそれぞれ 3.4 5 × 10 4 および 5.7 3 × 10 4 のポリイミド前駆体を得ることができた。

このポリイミド前駆体をNMP及びBCの混合溶媒(重量比4:1)により総固形分4%の溶液に調製した。この溶液をガラス基板上に4000rpmでスピンコートし、ついで80℃で5分乾燥した後、250℃で1時間熱処理を行うことにより、厚さ1000Åのポリイミド樹脂膜を作製した。実施例と同様に、ポリイミド樹脂膜に偏光紫外線波長240nm~280nmを1時間または300nm~330nmを15分間照射した後、液晶セルを作製した。これらのセルを偏光顕微鏡のクロスニコル下で回転させたところ、若干の明暗を生じるものの、多数の欠陥が観測され、液晶は均一に配向しなかった。

比較例 5

ポリビニルシンナメート(分子量約20000)をモノクロロベンゼンとジクロロメタンの混合溶媒に溶解させ、総固形分2重量%の溶液を調製した。この溶液をガラス基板上に2000rpmでスピンコートし、ついで80℃で5分乾燥した後、100℃で1時間加熱処理を行うことにより、厚さ1000Åの塗膜を作製した。このポリビニルシンナメート膜に、実施例と同様に波長300nm~330nmの偏光紫外線を60秒間照射し、液晶セルを作製した。このセルを偏光顕微鏡のクロスニコル下で回転させたところ、明瞭な明暗を生じ、且つ欠陥も観測されず、均一な液晶の配向が得られるものの、液晶セルを120℃のオーブン中で加熱処理を1時間行い、室温まで冷却した後偏光顕微鏡のクロスニコル下で液晶セルを観測したところ、多数の欠陥が観測され、加熱処理前の液晶の配向は保持されず、配向が乱れていることが確認された。

比較例6

窒素気流下、CBDA1.92g(9.8 mmol)と2,2 ービス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン4.10g(10.0 mmol)を、NMP40.13ml中、室温で3時間反応させポリイミド前駆体溶液を調製した。重合反応は容易且つ均一に進行した。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた数平均分子量及び重量平均分子量がそれぞれ2.74×104及び4.19×104のポリイミド前駆体を得ることができた。

このポリイミド前駆体をNMP及びBCの混合溶媒(重要比4:1)により総固形分4%の溶液を調製した。この溶液をガラス基板上に4300rpmでスピンコートし、ついで80℃で5分乾燥した後、250℃で1時間熱処理を行うことにより、厚さ1000点のポリイミド樹脂膜を作製した。実施例と同様に、ポリイミド樹脂膜に波長240nm~280nmの偏光紫外線を12分間照射した後、液晶セルを作製した。このセルを偏光顕微鏡のクロスニコル下で回転させたところ、明瞭な明暗を生じ、且つ欠陥も観測されず、均一な液晶の配向が得られるものの、液晶セルを120℃のオーブン中で加熱処理を1時間行い、室温まで冷却した後偏光顕微鏡のクロスニコル下で液晶セルを観測したところ、多数の欠陥が観測され、加熱処理前の液晶の配向は保持されず、配向が乱れていることが確認された。

比較例7

窒素気流下、CBDA1.92g(9.8mmo1)と実施例34に表記したジアミン化合物(III)2.40g(10.0mmo1)を、NMP23.86ml中、室温で6時間反応させポリイミド前駆体溶液を調製した。重合反応は容易且つ均一に進行した。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた数平均分子量及び重量平均分子量がそれぞれ6.64×10 4 及び1.08×10 5 のポリイミド前駆体を得ることができた。

このポリイミド前駆体をNMP及びBCの混合溶媒(重要比4:1)により総固形分4%の溶液を調製した。この溶液をガラス基板上に4300rpmでスピンコートし、ついで80℃で5分乾燥した後、250℃で1時間熱処理を行うことにより、厚さ1000Aのポリイミド樹脂膜を作製した。実施例と同様に、ポ

リイミド樹脂膜に偏光紫外線波長240nm~280nmを1時間または300nm~330nmを15分間照射した後、液晶セルを作製した。これらのセルを偏光顕微鏡のクロスニコル下で回転させたところ、若干の明暗を生じるものの、多数の欠陥が観測され、液晶は均一に配向しなかった。

比較例8

窒素気流下、CBDA1.92g(9.8mmol)と実施例38に表記したジアミン化合物(IV)3.60g(10.0mmol)を、NMP24.96ml中、室温で6時間反応させポリイミド前駆体溶液を調製した。重合反応は容易且つ均一に進行した。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで求めた数平均分子量及び重量平均分子量がそれぞれ6.73×10³及び1.17×10⁴のポリイミド前駆体を得ることができた。

このポリイミド前駆体をNMP及びBCの混合溶媒(重要比4:1)により総固形分6%の溶液に調製した。この溶液をガラス基板上に2400rpmでスピンコートし、ついで80℃で5分乾燥した後、250℃で1時間熱処理を行うことにより、厚さ1000Aのポリイミド樹脂膜を作製した。実施例と同様に、ボリイミド樹脂膜に偏光紫外線波長240nm~280nmを1時間または300nm~330nmを15分間照射した後、液晶セルを作製した。これらのセルを偏光顕微鏡のクロスニコル下で回転させたところ、若干の明暗を生じるものの、多数の欠陥が観測され、液晶は均一に配向しなかった。

産業上の利用可能性

本発明の液晶配向処理剤を用いて基板上に形成された高分子薄膜は、光または電子線を照射することにより、従来の液晶配向処理方法であるラビング処理を行うことなしに、液晶分子を均一且つ安定に配向させることができる。更に、その配向は熱的安定性及び耐光性を有するものである。従って、本発明の液晶配向処理剤により、液晶素子の工業的生産性の向上が計れる。

請 求 の 範 囲

1. 液晶配向処理剤を用いて基板上に形成された高分子薄膜に光または電子線を基板面に対して照射し、次いで該基板上にラビング処理なしに液晶を配向させる方法において用いられるところの液晶配向処理剤であって、高分子主鎖中に下記一般式(1)~(7)

(R'、R'及びR'はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリル基またはプロパルギル基を表す。)

で表されるいずれかの結合を有し、上記結合の両端に2価または3価の芳香族基が直接結合するか、または上記結合の片端に2価または3価の芳香族基が直接結合しかつもう一方の片端に2価または3価の脂環式炭化水素基が直接結合する数平均分子量が1000~300000高分子化合物からなる、液晶配向処理剤。

2. 光または電子線の照射により二量化反応または異性化反応が誘起される置換基として、下記一般式(8)~(17)

(R⁴、R⁵、R⁶、R⁷、R⁸及びR⁹はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、置換アルキル基、置換アルコキシ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基またはシアノ基を表す。)

で表される官能基を高分子主鎖または側鎖中に持たない請求項1記載の液晶配向 処理剤。

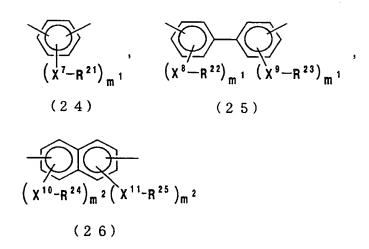
- 3. 高分子化合物がポリアミドであることを特徴とする請求項1または2記載の液晶配向処理剤。
- 4. 高分子化合物が、一般式 (18) または、一般式 (19a) 及び (19b)

(R¹⁰、R¹¹、R¹²及びR¹³は一般式(20)~(23)

$$(x^{1}-R^{14})_{m} \stackrel{!}{_{1}} (x^{2}-R^{15})_{m} \stackrel{!}{_{1}} (x^{3}-R^{16})_{m} \stackrel{!}{_{1}} (x^{4}-R^{17})_{m} \stackrel{!}{_{2}} (20) \qquad (21) \qquad (22)$$

$$(x^{5}-R^{18})_{m} \stackrel{!}{_{1}} (x^{6}-R^{19})_{m} \stackrel{!}{_{1}} (23)$$

 $(X^1, X^2, X^3, X^4, X^6$ 及び X^6 はそれぞれ独立に単結合、O、 CO_2 、OCO、 CH_2O 、NHCOまたはCONHを表し、 R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} 、 R^{17} 、 R^{18} 及び R^{19} はそれぞれ独立に水素原子、Nロゲン原子、 $C_1 \sim C_{24}$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_{24}$ の含フッ素アルキル基、アリル基、プロパルギル基、フェニル基または置換フェニル基を表し、 Y^1 はO、S、CO、 CO_2 、 SO_2 、 CH_2 、NH、NHCO、 $Y^2 - Ar^1 - Y^3$ 、 $Y^4 - (CH_2)$ $n^1 - Y^5$ 、または $Y^6 - Ar^2 - R^{20} - Ar^3 - Y^7$ を表し、 Y^2 、 Y^3 、 Y^4 、 Y^5 、 Y^6 及び Y^7 はそれぞれ独立EO、S、EO、EO2、EO2、EO3、EO4、EO5 の直鎖状もしくは分岐状の低級アルキレン基、フルオロアルキレン基もしくはアルキレンジオキシ基を表し、EO6 に、EO7 をなびEO8 を表し、EO9 に、EO9 に EO9 に E



(X⁷、X⁸、X⁹、X¹⁰及びX¹¹はそれぞれ独立に単結合、O、CO₂、OCO、

 CH_2O 、NHCOまたはCONHを表し、 R^{21} 、 R^{22} 、 R^{23} 、 R^{24} 及び R^{25} は それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、 $C_1\sim C_{24}$ のアルキル基、 $C_1\sim C_{24}$ の含フッ素アルキル基、アリル基、プロパルギル基、フェニル基または置換フェニル基を表し、 m^1 は $1\sim 4$ の整数を表し、 m^2 は $1\sim 3$ の整数を表す。ただし、 R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} 、 R^{17} 、 R^{18} 、 R^{19} 、 R^{21} 、 R^{22} 、 R^{23} 、 R^{24} 及び R^{25} が水素原子またはハロゲン原子を表す場合には、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 X^4 、 X^5 、 X^6 、 X^7 、 X^8 、 X^9 、 X^{10} 及び X^{11} は単結合を表す。)

で表される基を示す。)

で表される2価の有機基を示し、R*1、R*2、R*3及びR*4はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリル基またはプロパルギル基を表す。)

で表される繰り返し単位を含むポリアミドである請求項3の液晶配向処理剤。

5. 上記一般式 (18) に於けるR'®及びR'1、または一般式 (19a) 及び (19b) に於けるR'2及びR'3がそれぞれ独立に下記式 (27) ~ (41)

で表される基から選ばれるものである、請求項3または4記載の液晶配向処理剤。

- 6. 高分子化合物が、ポリイミド前駆体またはそのポリイミド前駆体を化学的または熱的にイミド化して得られるポリイミドであることを特徴とする請求項1または2記載の液晶配向処理剤。
 - 7. 高分子化合物が、下記一般式 (42a) または (42b)

(R²⁶は4価の有機基を表し、R²⁶は3価の有機基を表し、R²⁷は2価または 3価の芳香族基または脂環式炭化水素基と結合したアミド基を含有する2価の有 機基を表す。)

で表される繰り返し単位を含むポリイミド前駆体またはそのポリイミド前駆体を 化学的または熱的にイミド化して得られるポリイミドである請求項6記載の液晶 配向処理剤。

8. 上記一般式 (42a) 及び (42b) に於いて、R²が下記一般式 (43) ~ (48)

 $(X_{-}^{12} \sim X_{-}^{30}$ はそれぞれ独立に単結合、O、 CO_{2} 、OCOまたは $CH_{2}O$ を表し、 $R^{28} \sim R^{46}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、 $C_{1} \sim C_{24}$ のアルキル基、 $C_{1} \sim C_{24}$ の含フッ素アルキル基、アリル基、プロパルギル基、フェニル基また

は置換フェニル基を表し、R *5 ~R *15 はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリル基またはプロパルギル基を表し、Y *8 及びY *9 はO、S、SO $_{2}$ 、CH $_{2}$ 、NH、NHCOまたはCONHを表し、m 1 は1~4の整数を表す。ただし、R 28 ~R 46 が水素原子またはハロゲン原子を表す場合には、X 12 ~X 30 は単結合である。)

で表される基から選ばれるものである請求項6または請求項7記載の液晶配向処理剤。

9. 上記一般式 (42a) 及び (42b) に於いて、R²⁷が下記式 (49) ~ (56)

 $(R^{47}$ はハロゲン原子、 $C_1 \sim C_{24}$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_{24}$ のアルコキシ基または $C_1 \sim C_{24}$ のアルコキシカルボニル基を表す。)

で表される基から選ばれるものである請求項6乃至請求項8のいずれかの請求項に記載の液晶配向処理剤。

10. 高分子化合物がポリウレタンであることを特徴とする請求項1または請求項2記載の液晶配向処理剤。

11. 高分子化合物が、下記一般式(57)

£.

(R48及びR49はそれぞれ独立に下記式(58)~(69)

.)

で表される基から選ばれ、R *16及びR *17はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリル基またはプロパルギル基を表す。)

で表される繰り返し単位を含むポリウレタンである請求項10記載の液晶配向処理剤。

- 12. 高分子化合物がポリウレアであることを特徴とする請求項1または請求項2記載の液晶配向処理剤
 - 13. 高分子化合物が、下記一般式 (70)

(R^{50} 及び R^{51} はそれぞれ独立に上記式(58)~(69)で表される基から選ばれ、 R^{a18} ~ R^{a21} はそれぞれ水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリル基またはプロパルギル基を表す。)

で表される繰り返し単位を含むポリウレアである請求項12記載の液晶配向処理剤。

- 14. 請求項1乃至請求項13のいずれかに記載の液晶配向処理剤を用いてなる液晶素子。
- 15. 液晶配向処理剤を用いて基板上に形成された高分子薄膜に光または電子線を基板面に対して照射し、次いで該基板上にラビング処理なしに液晶を配向させる方法に於いて、請求項1乃至13のいずれかの請求項に記載の液晶配向処理剤を用いることを特徴とする液晶の配向方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/04575

		<u>.l</u>					
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁶ G02F1/1337							
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
	SEARCHED						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁶ G02F1/1337							
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999							
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)							
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
Х	JP, 4-288365, A (Shin-Etsu Chem 13 October, 1992 (13.10.92) (nical Co., Ltd.), Family: none)	1,2,6,7,14,15				
х	JP, 4-116557, A (Sumitomo Bakel: 17 April, 1992 (17.04.92) (Fa	1,3~7,14,15					
A	JP, 4-284421, A (Agency of Indu Technology), 09 October, 1992 (09.10.92) (1~15					
A	JP, 4-288365, A (Shin-Etsu Chem 13 October, 1992 (13.10.92) (12,13					
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.							
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the intern priority date and not in conflict with the understand the principle or theory underdocument of particular relevance; the claimed considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular re			ne application but cited to erlying the invention celaimed invention cannot be red to involve an inventive claimed invention cannot be p when the document is a documents, such a skilled in the art family				
19 November, 1999 (19.11.99)		30 November, 1999 (30.11.99)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer					
Facsimile No.		Telephone No					

•



国際出願番号 PCT/JP99/04575

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁶ G02F1/1337

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C16 G02F1/1337

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-1999年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献						
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号				
X	JP、4-288365, A (信越化学工業株式会社) 13.10 月.1992(13.10.92) (ファミリーなし)	1, 2, 6, 7, 14, 15				
X	JP、4-116557, A(住友ベークライト株式会社)17. 4月.1992(17.04.92)(ファミリーなし)	1, 3~7, 1 4, 15				
A	JP、4-284421, A(工業技術院長)9.10月.199 2(09.10.92)(ファミリーなし))	1~15				
A	JP、4-288365, A (信越化学工業株式会社) 13.10月.1992(13.10.92) (ファミリーなし)	12, 13				

□ C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

19.11.99

国際調査報告の発送日

30.11.99

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官 (権限のある職員) 藤岡 善行 2 X | 9 2 2 5

電話番号 03-3581-1101 内線 3295

		i
•		÷-
(•)		